# O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI HUZURIDAGI YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASI VA MIKROELEKTRONIKA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12 RAQAMLI ILMIY KENGASH

# O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI HUZURIDAGI YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASI VA MIKROELEKTRONIKA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

## NORBEKOV SHOHZOD MAMARASUL O'G'LI

# TABIIY TOLALARNING YARIMO'TKAZGICH XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH VA ULAR ASOSIDA DISKRET ASBOBLAR YARATISHNI TAVSIYA QILISH

01.04.10 - Yarimo'tkazgichlar fizikasi

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD)
DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

# Fizika-matematika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati mundarijasi

# Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по физико-математическим наукам

# Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD) on physical-mathematical sciences

Tabiiy tolalarning yarimoʻtkazgich xususiyatlarini tadqiq qilish va ular asosida diskret asboblar yaratishni tavsiya qilish	3
Норбеков Шохзод Мамарасулович	
Исследование полупроводникових свойств природных волокон и	
рекомендации по созданию дискретных приборов на их основе	23
Norbekov Shokhzod	
Investigation of the semiconductor properties of natural fibers and	
recommend the creation of discrete devices based on them	43
E'lon qilingan ishlar roʻyxati	
Список опубликованных работ	
List of published works	47

# O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI HUZURIDAGI YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASI VA MIKROELEKTRONIKA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12 RAQAMLI ILMIY KENGASH

# O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI HUZURIDAGI YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASI VA MIKROELEKTRONIKA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

## NORBEKOV SHOHZOD MAMARASUL O'G'LI

# TABIIY TOLALARNING YARIMO'TKAZGICH XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH VA ULAR ASOSIDA DISKRET ASBOBLAR YARATISHNI TAVSIYA QILISH

01.04.10 - Yarimo'tkazgichlar fizikasi

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD)
DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

Fizika-matematika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi mavzusi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestasiya komissiyasida B2022.4.PhD/FM819 raqam bilan roʻyxatga olingan.

Dissertasiya Oʻzbekiston Milliy universiteti huzuridagi Yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot institutida bajarilgan.

Dissertasiya avtoreferati uch tilda (oʻzbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengashning veb-sahifasida (www.ispm.uz) va «ZiyoNet» Axborot-ta'lim portalida (www.ziyonet.uz) joylashtirilgan.

Ilmiy raxbar:

Mamadalimov Abdugʻafur Teshabaevich fizika-matematika fanlari doktori, akademik

Rasmiy opponentlar:

Zikrillayev Nurilla Fatxullayevich fizika-matematika fanlari doktori, professor

Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich fizika-matematika fanlari doktori, professor

Yetakchi tashkilot:

Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti

Dissertatsiya himoyasi Oʻzbekiston Milliy universiteti huzuridagi Yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruychi DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12 raqamli Ilmiy kengashning 2024 yil «26» 0.7 soat /2 dagi majlisida boʻlib oʻtadi. (Manzil: 100057, Oʻzbekiston, Tashkent sh., Yangi Olmazor koʻchasi, 20-uy, Tel.: (+99871)248-79-94, faks: (+99871)248-79-92, e-mail: info@ispm.uz.)

Dissertatsiya bilan institutning Axborot-resurs markazida tanishish mumkin. (63 raqam bilan roʻyxatga olingan). (Manzil: 100057, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Yangi Olmazor koʻchasi, 20-uy. Tel.: (+99871) 248-79-59; e-mail: info@ispm.uz).

Dissertatsiya avtoreferati 2024 yil «/// » \_\_\_\_\_\_ kuni tarqatildi. (2024 yil «/// » \_\_\_\_\_\_ dagi \_\_\_\_\_ arqamli reestr bayonnomasi).

Sh.B. Utamuradova
Ilmiy darajalar beruvchi
Grip kengash rais F.-m.f.d., professor

J.J. Hamdamov
Ilmiy darajalar beruvchi
Ilmiy kengash ilmiy kotibi, PhD, k.i.x.

Ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi, f.-m.f. d., dotsent

## KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining annotatsiyasi)

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurligi. Jaxonda bugungi kunda jadal rivojlanayotgan yarimoʻtkazgichlar fizikasi sohasida dolzarb yoʻnalishlaridan biri boʻlgan tabiiy yarimoʻtkazgichlarning fizikaviy xossalarini aniqlash boʻyicha ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dunyo miqyosida tabiiy yarimoʻtkazgich tolalarni keng miqyosda va kompleks tadqiq qilish yangi fizikaviy qonuniyatlarini namoyon qilish va ular asosida elektron texnikani juda ilgʻor yangi diskret elementlarini yaratish va amaliyotga joriy etishni taqozo etadi.

Bugungi kunda jaxonda tabiiy yarimo'tkazgichlardagi fizik jarayonlarni tadqiq qilishga yoʻnaltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa nanofizika sohasida tabiiy tolalarning oʻrni alohida ahamiyatga ega. Shu jihatdan bu yoʻnalishda eng muhim vazifalardan biri quyidagi maqsadli ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish: tabiiy yarimo'tkazgichli tolalarning fundamental parametrlarini aniqlash; tabiiy yarimo'tkazgichli tolalarga kimyoviy, termik va radioaktiv ishlov berish orgali uning elektrofizik, fotoelektrik va optik xususiyatlarining samaradorligini oshirish; elektro'tkazuvchanlikni haroratga va yorug'lik spektriga bogʻliqlik qonuniyatlarini namoyon qilish; legirlangan yarimoʻtkazgichli paxta va bambuk tolalarini elektr o'tkazuvchanligini legirlash vaqti va haroratga bog'liqlik qonuniyatlarini aniqlash; elektron texnikani yangi elementlarini yaratish; har xil tabiiy yarimo'tkazgichli tolalarda kechadigan elektron iarayonlarning mexanizmlarini oʻrganish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Respublikamizda ilmiy tadqiqotchilar tabiiy tolalarning fizik samaradorligini yanada oshirish ustida ishlamoqdalar. Bu borada yangi turdagi tabiiy yarimoʻtkazgich tolalarni yaratish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan bambuk va paxta tolalari asosidagi yarimoʻtkazgich materiallarning optimal elektrofizik, fotoelektrik va optik xususiyatlarini hisobga olganda arzon va ekologik toza materialdan biri hisoblanadi. Tabiiy tolalardan passiv hamda aktiv elementlarni oʻz ichiga olgan "Aqlli kiyim texnologiyasi" (Smart Clothing Technology) toʻqimachilik sxemasini amalga oshirish imkoniyatini koʻrsatadi. Bu kelajakda elektronika va toʻqimachilik oʻrtasida integratsiyaga yoʻl ochadi. Adabiyotlarda tabiiy tolalarning fizik xususiyatlarini tadqiq etish boʻyicha ma'lumotlar juda kam va ularning elektrofizik qonuniyatlar bilan bogʻliq koʻplab hal qilinmagan muammolar mavjud.

Ushbu dissertatsiya Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida"gi PF-6097-son farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida"gi PF-60-son farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-martdagi "Elektrotexnika va elektronika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi PQ-5011-son qarori, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» gi PQ-5032-son qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy

hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertasiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yoʻnalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining III. «Energiya, energiya resurslarini tejash, transport, mashinasozlik va asbobsozlik; zamonaviy elektronika, mikroelektronika, fotonika, elektron asbobsozlikni rivojlantirish» ustuvor yoʻnalishlariga muvofiq bajarilgan.

Muammoning oʻrganilganlik darajasi: Kimyoviy va termik ishlov berilgan tabiiy tolalarning elektrofizik va optik xossalarini ilmiy tadqiq qilish bir qator xorijiy rivojlangan mamlakatlarning ilmiy-tadqiqot institutlari va ilmiy markazlarida olib borilmoqda. Jumladan, tabiiy paxta tolalarida organik elektronika AQSHning Kornel universiteti olimi P.Hinestoroza, Italiyaning Boloniya universiteti olimi F.Beatrice va Fransiyaning Provans mikroelektronika markazi olimi G.Malliaras tomonidan oʻrganildi.

Tojikiston davlat milliy universitetida A.Akobirova, S.Misriyon, Sh.Tuychiev, A.Aloviddinovlar tomonidan  $C_{60}$  fullerenlarni tabiiy tolalarning elektr oʻtkazuvchanligiga ta'siri oʻrganildi.

Oʻzbekistonlik olimlar, jumladan, akademiklar P.K.Habibullaev va A.T.Mamadalimov tomonidan dunyoda birinchi marta paxta va ipak tolalarining yarimoʻtkazgichli xususiyatlari namoyon qilingan. Professorlar A.S.Zakirov, Sh.U.Yuldashev, J.J.Hamdamov va boshqalar tomonidan yarimoʻtkazgichli tabiiy tolalarning elektrofizik va optik xususiyatlari tadqiq qilindi va turli yarimoʻtkazgichli qurilmalarni yaratish koʻrsatildi.

Elektrofizik va optik xususiyatlarini oʻrganish ushbu yoʻnalishdagi tadqiqotlarning keng imkoniyatlarini koʻrsatadi. Ammo shu paytgacha tabiiy nanostrukturali yarimoʻtkazgich tolalarining elektrofizik va optik xususiyatlari, shuningdek umumiy fizik qonunlari haqida hali ham ma'lumot yetarli emas.

# Dissertatsiya mavzusining bajarilgan oliy ta'lim muassasasi ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bogʻliqligi.

Dissertatsiya ishi Oʻzbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalar agentligi grantlarining tematik planlariga mos ravishda M.Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti ilmiy tadqiqot rejasining: OT-F2-29 "Tabiiy tolalarning fizik xossalariga tashqi faktorlarni ta'sirini oʻrganish"(03.01.2017-31.12.2020 yy.) mavzusidagi fundamental loyiha doirasida bajarilgan.

**Tadqiqotning maqsadi** tabiiy yarimoʻtkazgichli bambuk hamda paxta tolalarining elektrofizik va optik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

# Tadqiqot vazifalari:

KMnO<sub>4</sub> va yod bilan legirlangan bambuk tolalari hamda "Komolot-79" va "Xorazm-150" navli paxta tolalarining fotooʻtkazuvchanlik spektrini, elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqlik qonuniyatini, shuningdek taqiqlangan zonadagi diskret energetik sathlarni aniqlash;

 $\gamma$ -<sup>60</sup>Co nurlanish manbaida nurlantirilgandan keyin yod bilan legirlangan paxta va bambuk tolalarining elektrofizik xususiyatlariga tashqi omillarning ta'sirini aniqlash;

tabiiy yarim o'tkazgichli paxta va bambuk tolalarining fotoo'tkazuvchanlik kinetikasini aniqlash;

kimyoviy, termik va radioaktiv ishlov berilgan paxta va bambuk tolalari namunalarining xususiyatlarini aniqlash;

"Komolot-79" va "Xorazm-150" navli paxta tolalarining fotoluminesensiya spektrini aniqlash;

tabiiy paxta va bambuk tolalar asosida datchiklar yaratishni tavsiya qilish.

**Tadqiqotning ob'ekti** sifatida bambuk tolalari, "Komolot-79" va "Xorazm-150" navli paxta tolalari olingan.

**Tadqiqotning predmeti** bambuk va paxta tolalarining elektroʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligini, fotooʻtkazuvchanlik va fotoluminesensiya spektrlarini oʻrganish hisoblanadi.

**Tadqiqot usullari.** Ilmiy ishni bajarish jarayonida IQ-spektroskopiya, paxta va bambuk tolalarining chuqur satxdagi ionlashuvchi energiyasini, haroratning elektr oʻtkazuvchanligiga bogʻliqligi, fotoelektr oʻtkazuvchanlik spektrini, spektrofotometrik analiz va fotoluminesensiya spektrini yuqori aniqlik bilan oʻlchashga imkon beradigan zamonaviy usullardan foydalanildi.

### **Tadqiqotning ilmiy yangiligi** quyidagilardan iborat:

yod bilan legirlangan bambuk tolalaridan va "Komolot-79" navli paxta tolalaridan oʻtayotgan tok qiymati harorat ortishi bilan eksponensial qonuniyat boʻyicha ortishi va aktivatsiya energiyalari mos ravishda  $E_{t1}=E_c-0,57$  eV va  $E_{t2}=E_c-0,83$  eV ekanligi aniqlangan;

ilk bor λ=254 nm to'lqin uzunlikdagi yorugʻlik bilan yoritilganda (hv≥E<sub>g</sub>) yod bilan legirlangan bambuk tolalarida fotooʻtkazuvchanlikning uzoq muddatli (250 s) relaksatsiyasi aniqlangan va ularning klassik zona diagrammasi tavsiya qilingan;

ilk bor yod bilan legirlangan "Xorazm-150" navli paxta tolalari namunalarida manfiy fotoo tkazuvchanlik fenomeni qayd qilingan;

ilk marotaba "Xorazm-150" navli paxta tolalarini KMnO<sub>4</sub> bilan 80 °C haroratda 1, 3 va 6 soat davomida legirlangan va ushbu legirlash vaqti ortishi bilan tolalarning elektro tkazuvchanligi nochiziqli ortishi aniqlangan;

ilk bor  $\gamma$ - $^{60}$ Co bilan nurlantirilgan bambuk tolalari va "Komolot-79" navli paxta tolalarining elektroo tkazuvchanligi  $\gamma$  nurlanish dozasiga bogʻliqligi aniqlangan va  $1.2 \cdot 10^6 \div 28.4 \cdot 10^6$  ren diapazonidagi radioaktiv nurlanish tabiiy tolalarda Frenkel nuqsonlarini hosil qilishi aniqlangan;

ilk bor KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan bambuk tolalari uchun aktivatsiya energiyasi  $E_{t1}$ =1,05 eV, "Xorazm-150" navli paxta tolalari uchun esa  $E_{t2}$ =0,54 eV ga tengligi hamda ushbu tolalardan 80 V kuchlanishda oʻtayotgan tok harorat ortishi bilan eksponensial qonun boʻyicha ortishi aniqlangan.

# Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

tabiiy yarimoʻtkazgich tolalarini oʻrganish uchun namuna tayorlash, kimyoviy, termik va radioaktiv ishlov berish hamda omik kontaktlarni olish texnologiyasi ishlab chiqilgan;

tabiiy yarimoʻtkazgichli bambuk va paxta tolalari asosida havo va boshqa ob'ektlarning nisbiy namligini oʻlchash imkonini beruvchi namlik datchigi shuningdek tolalarni termik, kimyoviy va radiaktiv nur bilan ishlov berish orqali elektrofizik xususiyatlarini boshqarish va bu natijalar asosida aqlliy kiyim aktuatorlari (smart clothing actuators) sifatida qoʻllash mumkinligi aniqlangan.

**Tadqiqot natijalarining ishonchligi** raqamliy yuqori sezuvchanlik va aniqlikka ega boʻlgan tadqiqot usullaridan foydalanish, shuningdek turliy usullarga ("Cary Eclipse Fluorescence Spectrometer", "Bruker Invenio S-2021 Fourier transformator spektrometr", "Eye-One Pro mini-spektrofotometr") tayangan holda olingan natijalarning bir necha bor takroran olinishi bilan asoslanadi.

**Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.** Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundan iboratki, tabiiy yarimoʻtkazgichli bambuk va paxta tolalarining fizikaviy qonuniyatlarini ochib beradi. Olingan natijalar tabiiy tolalarning fizik xususiyatlariga oid nazariy bilimlarni kengayishiga olib kelishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundan iboratki, yarimoʻtkazgichli xususiyatga ega boʻlgan yangi polimer materiallar aniqlanganligi va ushbu material orqali turli ob'ektlarning nisbiy namligini oʻlchash uchun namlik datchiklarini yaratishda hamda magistratura va bakalavriat ta'lim jarayonida qoʻllanilishi mumkin.

### Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi.

Paxta va bambuk tolalarining yarimoʻtkazgich xossalarini oʻrganish boʻyicha olingan ilmiy natijalar asosida:

Paxta tolalarining radioaktiv, kimyoviy va termik ishlov berilishi tufayli olingan noyob fotosezgirlikka egaligi hamda haroratning oʻzgarishi jarayonida elektroʻtkazuvchanlik gisterezisi yoʻqligi kabi noyob ilmiy natijalardan «FOTON» AJ da tayyorlangan yarimoʻtkazgich elektron namunalardan foydalanish uchun sinovdan oʻtkazilgan ("Oʻzeltexsanoat" aktsiyadorlik kompaniyasining 2023-yil 18-sentyabrdagi №-04-3/1234-son ma'lumotnomasi). Keltirilgan ilmiy natijalardan foydalanish natijasida tajribaviy namunalardan elektron sxema tuzishda, harorat va yorugʻlikka sezgir elementlar ishlab chiqarishga tavsiya berilgan;

dissertasiya doirasida ishlab chiqilgan texnologik rejimlar asosida radioaktiv va kimyoviy ishlov berilib, yod hamda KMnO₄ bilan legirlangan seluloza tolalaridan Namangan muhandislik-qurilish institutida bajarilgan OT-F2-70 raqamli "Kuchli elektromagnit maydondagi nano o'lchamli yarimo'tkazgich parametrlariga harorat, deformatsiya va yorug'lik ta'siri" mavzusidagi loyixaning ilmiy texnikaviy vazifalarini bajarishda, jumladan loyixa doirasida qizdiruvchi o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydonda gomo va geterostrukturalar ilk marta olinib, ularning elektrofizik va fotoelektrik xossalarini oʻrganishda qoʻllanilgan (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 25-dekabrdagi №-4/17-13/0-09-1142-son ma'lumotnomasi). Ilmiy natijalardan foydalanish ushbu materiallar asosida qizdiruvchi o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydonda gomo va geterostrukturali noyob elektrofizik va fotoelektrik xossalariga ega boʻlgan materiallarni olish imkonini bergan.

**Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi.** Dissertatsiya ishining natijalari 9 ta, jumladan 6 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida taqdim qilinib muhokamadan oʻtkazilgan.

**Tadqiqot natijalarining e'lon qilinishi.** Dissertatsiya mavzusi boʻyicha jami 15 ta ilmiy ish chop etilgan, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan 3 tasi xorijiy va 2 tasi mahalliy jurnallarda nashr etilgan.

**Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi.** Dissertatsiya tarkibi kirish, toʻrt bob, xulosa, e'lon qilingan ilmiy ishlar roʻyxati, foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati, ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 106 betni tashkil etadi.

#### DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Kirish qismida dissertatsiya mavzusi boʻyicha turli tadqiqotchilar tomonidan olingan natijalar tahlili keltirilgan, dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati asoslangan, tadqiqotning maqsad va vazifalari shakllantirilgan, obʻekti va predmeti aniqlangan, tadqiqotning Oʻzbekiston Respublikasida fan texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlariga mosligi koʻrsatilgan, tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan, ularning ishonchliligi asoslangan, olingan natijalarning nazariy va amaliy ahamiyati ochib berilgan, ishlanmalarni amaliyotga joriy qilish, ishning aprobatsiyasi natijalari, e'lon qilingan ishlar va dissertatsiyaning tuzilishi toʻgʻrisida ma'lumotlar keltirilgan.

Dissertatsiyaning "Tabiiy tolalarning fizik xossalari bo'yicha adabiyotlar sharxi" deb nomlangan birinchi bobida bambuk va paxta tolalarining fizikaviy xossalari, kimyoviy tuzulishi va polimer material sifatida foydalanishning hozirgi holati tahlil etilgan. Mavjud nazariy va tajribaviy ma'lumotlar tahlili asosida tadqiqotning maqsadi va vazifalari shakllantirilgan.

Ishni bajarishda va tadqiqot vazifalarida belgilangan ilmiy izlanishlar quyidagilardan iborat: yod va KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan bambuk va paxta tolalarining fotooʻtkazuvchanligi va elektroʻtkazuvchanlikni haroratga bogʻliqligini aniqlash; yarimoʻtkazgichli bambuk va paxta tolalarining fotooʻtkazuvchanlik spektrini aniqlash, diskret energetik sathlarni aniqlash va legirlovchi elementlarning fotooʻtkazuvchanlik spektriga ta'sirini aniqlash; paxta tolalarining fotoluminesensiya spektrini aniqlash;

Disertatsiyaning "Tadqiqotlar olib borish uchun namunalar tayyorlash texnologiyasi va oʻlchash usullari" deb nomlangan ikkinchi bobida tabiiy tolalardan namunalar tayyorlash, tabiiy paxta va bambuk tolalariga kimyoviy, radioaktiv va termik ishlov berish usullari, tabiiy tolalarning elektrofizik, fotoelektrik va optik xususiyatlarini tadqid qilish metodlari va qurilmalar tavsifi bayon qilingan:

Tadqiqotlar oʻtkazish uchun oʻrta yoshdagi tabiiy sharoitda yetilgan bambuk poyasidan tola yoʻnalishida  $(4 \times 2 \times 0.8 \, mm^3)$  namuna tayyorlandi. Bambuk tolasidan (BT) tayyorlangan namuna 75 °C distillangan suv bilan yuvildi. Yuvilgan namunalar xona haroratida 24 soat davomida quritildi. BT yod bilan legirlash uchun xona haroratida yodning 7% spirtdagi eritmasi boʻlgan vannada namunalar 15 min davomida shimdirildi. Yuzaga qoplanga yodni tolaga diffuziya qilish uchun 75-80 °C haroratli havo kamerasida tadqiqot vazifasiga qarqab turli vaqtlarda (1-8 soat)

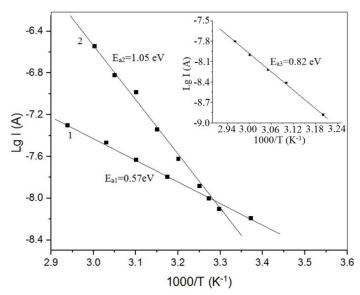
diffuziya qilindi. Bambuk tolasini KMnO<sub>4</sub> bilan legirlash uchun ham yuqoridagi jarayondan foydalanildi. KMnO<sub>4</sub> 1.5% etalonda suvdagi eritmasidan foydalanildi.

Paxta tolasidan (PT) namuna tayyorlash ham deyarli yuqoridagi tartib va sharoitda amalga oshirildi. Faqat yuvishgacha boʻlgan jarayon farq qiladi. Dastavval, pishib yetilgan paxta chigitidan tolalar tekis jism ustida parallel yoʻnalishda yotqizib olindi va maxsus taroq yodamida tola yoʻnalishida taraldi. Parallel joylashgan tolalarning taxminiy soni 4500-5000 dona va uzunligi 4 mm boʻlgan holatda kesib olindi.

Paxta va bambuk tolalariga kimyoviy ishlov berildi ya'ni, merserizatsiya qilindi. PT yuvilgandan soʻng 20% NaOH suvdagi eritmasi solingan vannada 18 °C haroratda 2 minut davomida ushlab turildi. Vannadan chiqarilgandan soʻng kimyoviy bogʻ hosil qilmagan ortiqcha NaOH distillangan suv bilan toʻliq yuvib tashlanadi va namunalar standart sharoitda quritiladi. Bu jarayon sellyuloza matritsasining ikkita barqaror boʻlmagan OH bogʻidagi vodorodni siqib chiqarib H oʻrnini Na egallaydi va jarayonda H<sub>2</sub>O ajralib chiqadi. Ushbu hodisa sellyuloza tolasining tashqi tasirlarga barqarorligini va kiritma kiruvchanligini oshiradi. Bambuk tolasi sellyulozasining OH bogʻi harakatchanligi juda past boʻlganligi uchun merserizatsiya vaqti 5 minutga oshirilgan.

Yuvilgan paxta va bambuk tolalari turli vaqtlar davomida ya'ni, 1 minutdan 120 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida 65.73 ren/s dozadagi  $\gamma$ -60Co nuranish manbai bilan radioaktiv ishlov berildi.

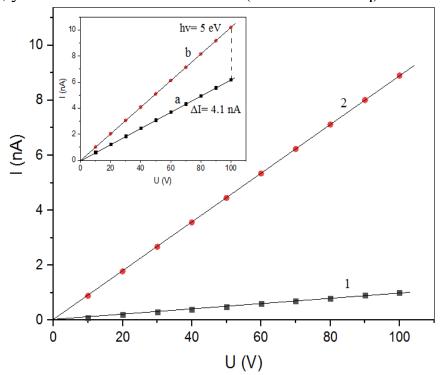
Dissertatsiyaning "Bambuk tolalarining fizik xossalarini tadqiq qilish" deb nomlangan uchinchi bobida ilgari tadqiq qilinmagan KMnO<sub>4</sub> va yod bilan legirlangan bambuk tolalarining fizikaviy xususiyatlarini oʻrganish natijalari keltirilgan.



1-rasm. Yod bilan legirlangan (1), KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan (2) va legirlanmagan (ichki grafik) BT namunalaridan oʻtayotgan elektr tokining haroratga bogʻliqligi.

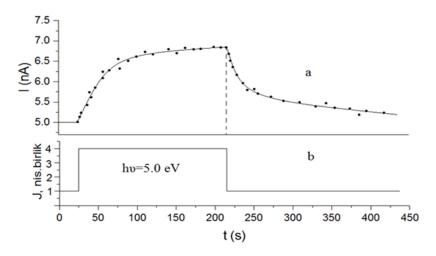
1-rasmda yod va KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan BT namunalariga doimiy U=80 V kuchlanish quyilganda oʻtayotgan elektr tokining haroratga bogʻliqligi keltirilgan (harorat diapazoni 20-80°C). Namunalar orqali oʻtayotgan elektr toki harorat ortishi bilan eksponensial qonuniyat boʻyicha ortishi kuzatildi.

Arrhenius qonuniga asoslangan  $10^3$ /T nisbatdagi harorat funksiyasi grafigining chiziqli qismidan olingan aktivatsiya energiyasi mos holda  $E_{a1}$ =0,57 eV,  $E_{a2}$ =1.05 eV,  $E_{a3}$ =0.82 eV ekanligi aniqlandi. Ushbu namunalarning volt-amper xarakteristikalari (VAX) tadqiq qilindi. Tadqiqotlar normal sharoitda, qorongʻuda va  $\lambda$ =254 nm toʻlqin uzunlikdagi nur ostida olib borildi. Namunalarga kiritma kiritish orqali oʻtkazuvchanlik oshganligi kuzatildi (2-rasm). Shuningdek, KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan BT  $\lambda$ =254 nm toʻlqin uzunlikdagi nur ostida statsionar holatga erishilgandan soʻng VAX olindi. Ultra binafsha (UB) nur bilan yoritilgan namunadan oʻtayotgan tok U=100 V oʻzgarmas kuchlanishda 6.1 nA dan 10.2 nA gacha oshdi, ya'ni ichki fotoeffekt kuzatildi (2-rasm. b-chiziq).



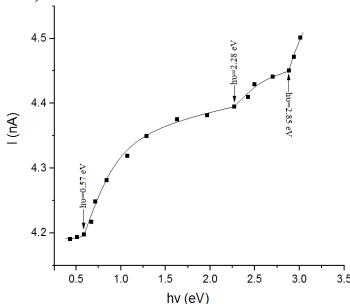
2-rasm. Legirlanmagan (1) va yod bilan legirlangan (2) shuningdek KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan (ichki rasm) BT, qorongʻuda (a) va UB nur (λ=254 nm) ostida (b)

Yod bilan legirlangan BT fotooʻtkazuvchanlik kinetikasi tekshirildi (3-rasm). Ushbu tadqiqot shuni koʻrsatadiki, UB nur ( $\lambda$ =254 nm) bilan yoritilganda fototokning eksponensial oʻsishi va UB nur oʻchirilganda fotooʻtkazuvchanlikning uzoq muddatli relaksatsiyasi kuzatildi. Bunda ichki fotoeffekt hodisasi namayon boʻlganligi qayd qilindi. Fotooʻtkazuvchanlikning statsionar qiymatiga bir zumda erishilmaydi ya'ni, yarimoʻtkazgichga yorugʻlik ta'siri boshlanganidan keyin ma'lum vaqt oʻtgach toʻyinish qiymatiga erishiladi (3-rasm).



3-rasm. Xususiy optik oʻtish bilan bogʻliq boʻlgan, yod bilan legirlangan BT fotooʻtkazuvchanlik kinetikasi

Yod bilan legirlangan BT fotooʻtkazuvchanlik spektri (FOʻ) (yorugʻlik spektri energiya diapazoni 0,26 eV dan 3,5 eV gacha) tadqiq qilindi (4-rasm). Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, namuna qorongʻida uzoq vaqt (1.5 soat) ushlab turilgandan keyin yorugʻlik spektri hv=0,57 eV dan boshlab fotooʻtkazuvchanlik sezilarliy darajada orta boshlagani kuzatildi. Foton energiyasi ortib borishi bilan maksimal hv=2,28 eV da kuzatildi va yorugʻlik nurining spektri taxminan hv=2,85 eV ga yetganda yana bir tok ortishi kuzatildi. Ushbu FOʻ spektrini BT taqiqlangan zona oraligʻining yuqori yarmida chuqur donor sathi mavjudligi bilan tushuntirish mumkin (4 va 5-rasm).



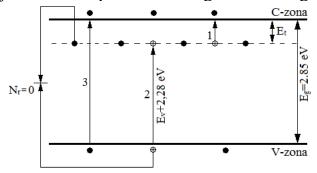
4-rasm. Yod bilan legirlangan BT fotooʻtkazuvchanlik spektri

Bu shuni koʻrsatadiki, ushbu BTnamunasining fotoo'tkazuvchanligi asosan zonalararo va zonalar orasidagi energetik sathlarda elektron-teshik juftligini hosil qilish jarayoni bilan bogʻliq. Agar yarimo'tkazgichlarning klassik zonalar modelidan foydalansak, BT uchun yuqoridagi fotoo'tkazuvchanlikni quyidagicha tushuntirish mumkin. Tajribalar shuni koʻrsatadiki, BT namunasini yod bilan legirlash fotosezgirlikni oshiradi. Bu faqat yod BT namunasining taqiqlangan zona oralig'ida chuqur sath hosil

qilgan taqdirdagina amalga oshadi. Yod taqiqlangan zona oraligʻining yuqori yarmida chuqur donor sath hosil qiladi deb faraz qilsak, FOʻ spektrining boshlanishi (hv=0,57~eV) BT tarkibidagi yodning ionlanish energiyasi, taqiqlangan zona kengligida  $E_c-0,57~eV$  chuqur sathni hosil qilganligi bilan bogʻliq. Agar yod bilan legirlangan BT n-tipli oʻtkazuvchanlikka ega ekanligini hisobga olsak, u holda

 $E_t$ = $E_c$ -0,57 eV boʻlgan sath, taqiqlangan zona kengligining yuqori yarmida joylashgan deb taxmin qilish mumkin. FOʻ spektri tahlili  $E_t$ = $E_c$ -0,57 eV boʻlgan sath donorlik xususiyatiga ega ekanligini koʻrsatadi. 0,57 $\leq$  hv $\leq$ 2,28 eV sohasida FOʻ monoton oʻsishi elektronlarning  $E_t$  sathidan C-zonasiga oʻtishi bilan bogʻliq (5-rasm 1-oʻtish). Fotooʻtkazuvchanlikning hv $\geq$ 2,28 eV dan boshlab yana oʻsishi elektronlarning V-zonadan  $E_t$  sathga oʻtishi bilan bogʻliq (2-oʻtish). Fototokning hv=2.85 eV dan boshlanadigan oʻsishi elektronlarning V-zonadan toʻgʻridan toʻgʻri C-zonaga oʻtishi bilan bogʻliq (3-oʻtish). Olingan natijalarni chuqur sath mavjud boʻlgan kremniyning umumiy qabul qilingan ma'lumotlar bilan solishtirganda, BT optik taqiqlangan zona kengligining qiymati  $E_g$ =0,57+2,28=2.85 eV ga teng ekanligi kelib chiqadi (ushbu qiymat BT spektrofotometrik analiz taxlili bilan ham tasdiqlangan 9-rasm).

Texnologik nuqtai nazardan legirlangan BT UB va koʻrinadigan nur diapazonini qayd qiladigan fotodetektor ekanligini koʻrsatadi. Legirlanmagan BT namunalarining oʻtkazuvchanlik qiymatlari juda past boʻlgan va UB nur tasirida juda kam miqdorda fotosezgirlik kuzatilgan.

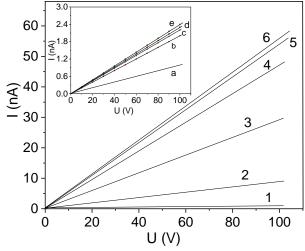


5-rasm. Yod bilan legirlangan BT zona diagrammasi

Yod bilan legirlangan BT namunasida fotooʻtkazuvchanlikning nomoyon boʻlishi, yod molekulalari va polimer zanjiri oʻrtasida fotoinduktsiyalangan zaryad almashinuvi bilan izohlanadi.

6-rasmda 65,73 ren/s miqdordagi nurlanish manbaiga ega boʻlgan  $\gamma$ - $^{60}$ Co nurlanish manbai bilan 1,2·10<sup>6</sup> ren, 2,8·10<sup>6</sup> ren, 5,7·10<sup>6</sup> ren, 28,4·10<sup>6</sup> ren miqdorda nurlantirilgan BT

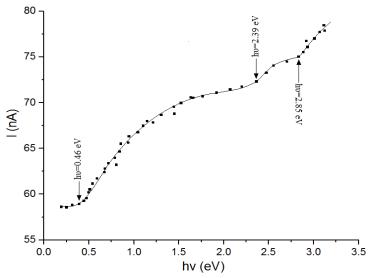
namunalarining VAX koʻrsatilgan. Barcha namunalarning geometrik oʻlchami va massasi bir xil. Sof BT namunasi (a chiziq), legirlanmagan faqat  $\gamma$ - $^{60}$ Co nurlanish manbasi bilan mos ravishda  $1,2\cdot10^6$  ren,  $2,8\cdot10^6$  ren,  $5,7\cdot10^6$  ren,  $28,4\cdot10^6$  ren miqdorda nurlantirilgan (b, c, d, e chiziqlar) namunalar bilan solishtirilgan.



6-rasm.  $\gamma$ -60Co nurlanish manbasi bilan ishlov berilgan BT VAX

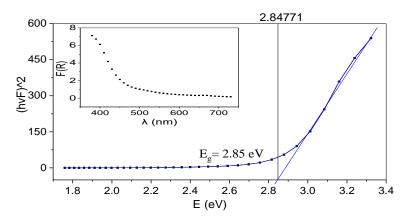
Natijalarga koʻra, γ-nur bilan ishlov berilgan namunalarning oʻtkazuvchanligi, nur dozasi ortishi tartibida kam miqdorda ortgan. Birinchi 5 soatlik nurlanish dozasidan keyingi dozlarda yuqori sezilarliy darajada ortmaganligi kuzatildi. Ammo turliy dozalarda γ-nur bilan ishlov berilgan va yod bilan legirlangan namunalarda buning aksi kuzatildi. 6-rasmda ishlov berilmagan (1-a), yod bilan legirlangan (2) va mos ravishda γ-<sup>60</sup>Co nurlanish manbasi bilan 1,2·10<sup>6</sup> ren, 2.8·10<sup>6</sup> ren, 5,7·10<sup>6</sup> ren, 28,4·10<sup>6</sup> ren miqdorda nurlantirilgan hamda yod bilan legirlangan (3), (4), (5), (6) chiziqlar. Natijalarga koʻra, faqat yod bilan legirlangan namunadan oʻtayotgan tok 100 V kuchlanishda I=8,9 nA ni tashkil qilgan va radiaktiv ishlov berilgan namunalarda esa nurlantirish dozasiga bogʻliq holda I=56 nA gacha tok oʻtganligi kuzatildi.

 $\gamma$ -nur bilan ishlov berilgan va yod bilan legirlangan BT FOʻ spektri oʻrganildi. Tajribalar shuni koʻrsatadiki, FOʻ uzun toʻlqin chegarasi hv=0,46 eV da joylashgan boʻlib, bu elektr oʻtkazuvchanligining haroratga bogʻliqligidan olingan ionlanish energiyasiga yaxshi mos keladi. Fototok hv=2,39 eV spektrda ham ma'lum miqdorda ortganligi namunada ikkilamchi optik oʻtish kuzatilganligini tasdiqlaydi. hv=2,85 eV da esa keskin ortganligi kuzatildi. BT tarkibidagi yod  $E_t$ = $E_c$ -0,46 eV chuqur donor sathni hosil qiladi va BT taqiqlangan zona energiya miqdori  $E_g$ =0,46+2,39=2,85 eV ga teng ekanligini tasdiqlaydi (7-rasm).



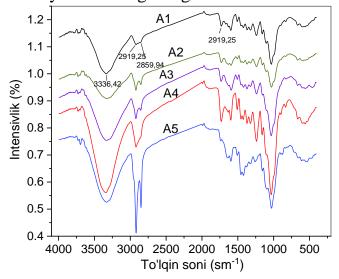
7-rasm. γ-nur bilan ishlov berilgan va yod bilan legirlangan BT fotoo'tkazuvchanlik spektri

BT taqiqlangan zona kengligi miqdorini spektrofotometrik analiz orqali aniqlandi. Zonalararo oʻtish energiyasining qiymatini olish uchun toʻgʻridan toʻgʻri optik oʻtishlar koordinatalarida Kubelka-Munk va Tauc yondashuvlari yordamida aniqlangan yutilishning spektral bogʻliqligidan foydalanildi (8-rasm). Sof BT uchun hv-(F(R)hv)² bogʻliqligini ekstrapolyatsiya qilish orqali topilgan taqiqlangan zona qiymati  $E_g \approx 2,85$  eV ga teng ekanligi aniqlandi. Bu esa BT tolalarining yarim oʻtkazgich xossasiga egaligidan hamda uning koʻrinadigan nur sohasida fotokatalitik faollikni namoyon qilish boʻyicha yuqori potensialga ega ekanligini koʻrsatadi.



8-rasm. Legirlanmagan sof BT uchun F(R) ning toʻlqin uzunligi (ichki rasm) va Tauc egri chiziqlariga (b) spektral bogʻliqligi

BT namunalarining tuzilishi oʻrganish uchun IQ spektroskopiya usulidan foydalanildi (9-rasm). A1 namuna sof BT, A2 namuna  $\gamma$ - $^{60}$ Co-nuranish manbai bilan 28,4· $10^6$  ren miqdorda nurlantirilgan BT, A3 namuna  $\gamma$ - $^{60}$ Co-nuranish manbai bilan 1,2· $10^6$  ren miqdorda nurlantirilgan BT, A4 namuna NaOH bilan kimyoviy ishlov berilgan BT, A5 namuna yod bilan legirlangan BT.



9-rasm. BT IQ spektroskopiya natijalari

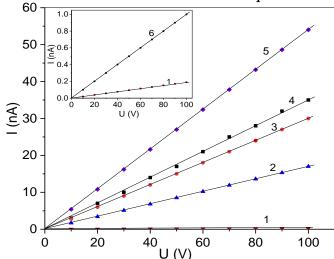
9-rasmda BT namunalarining IQ spektroskopiya natijalari keltirilgan. NaOH bilan kimyoviy ishlov berilgan BT A4 namunasini A1 namunaga nisbatan tahlil qilinganda OH guruhining yutulish chiziqlari 3336,42 sm<sup>-1</sup>, CH=CH guruhining yutulish chiziqlari 2919,25 sm<sup>-1</sup>, CH<sub>2</sub>-guruhining yutulish chiziqlari 2859,94 sm<sup>-1</sup>, C=O guruhining yutulish chiziqlari 1730,55 sm<sup>-1</sup> nomoyon boʻldi. A4 va A1 namunalarining yutulish spektrlari solishtirilganda deyarli oʻzgarish qayd qilinmagan (9-rasm). Natijaga koʻra BT NaOH bilan deyarli kimyoviy bogʻ hosil qilmagan. Buning sababi BT tarkibidagi OH guruhida kislota xossasi yoʻqligi uchun deyarli kimyoviy jarayon ketmagan deb xulosa qilish mumkin.

Yod (I<sub>2</sub>) bilan legirlangan BT A5 namunasini sof A1 namunaga nisbatan IQ spektroskopiya natijalari tahlil qilinganda quydagi oʻzgarishlar kuzatildi. OH guruhi 3336,42 sm<sup>-1</sup> dan 3334,87 sm<sup>-1</sup> ga, CH=CH guruhi 2919,25 sm<sup>-1</sup> dan 2918.35 sm<sup>-1</sup> ga, CH<sub>2</sub> guruhi 2859,94 sm<sup>-1</sup> dan 2850,59 sm<sup>-1</sup> ga, C=0 guruhi 1730,55 sm<sup>-1</sup> dan 1737,96 sm<sup>-1</sup> ga oʻzgardi, hamda I<sub>2</sub> ga tegishli yutilish chiziqlari 470,77 sm<sup>-1</sup> barmoq

izi sohasida kuzatildi. Shuni qoʻshimcha qilib aytish mumkinki barmoq izi sohasida yaqqol oʻzgarish kuzatilgan. BT yod bilan qisman ion, qisman kovalent va deformatsion bogʻlar bilan oʻzaro bogʻlangan.

BT  $\gamma$ -60Co nurlanish manbaida  $1.2 \cdot 10^6$  ren miqdorda nurlantirilgan A3 namunasining sof A1 namunasiga nisbatan IQ spektroskopiya natijalari tahlil qilinganda OH guruhi 3336,42 sm<sup>-1</sup> dan 3333,6 sm<sup>-1</sup> ga, CH=CH guruhi 2919,25 sm<sup>-1</sup> dan 2921,82 sm<sup>-1</sup> ga, CH<sub>2</sub> guruhi 2859,94 sm<sup>-1</sup> dan 2854,98 sm<sup>-1</sup> ga, C=0 guruhi 1730,55 sm<sup>-1</sup> dan 1731,98 sm<sup>-1</sup> sohaga surulgani kuzatildi.  $\gamma$ -60Co nurlanish manbaida 28.4·10<sup>6</sup> ren miqdorda nurlantirilgan A2 namunada esa quydagi natijalar qayd qilindi. OH guruhining yutilish chiziqlari 3336,42 sm<sup>-1</sup> dan 3325,37 sm<sup>-1</sup> ga, CH=CH guruhi 2919,25 sm<sup>-1</sup> dan 2921,45 sm<sup>-1</sup> ga, CH<sub>2</sub> guruhi 2859,94 sm<sup>-1</sup> dan 2853,3 sm<sup>-1</sup> ga, C=0 guruhi 1730,55 sm<sup>-1</sup> dan 1730,98 sm<sup>-1</sup> sohaga surulgani kuzatildi. Shuningdek A2 va A3 namunalarda barmoq izi sohasida oʻzgarish kuzatilmagan. Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, BT  $\gamma$ -60Co nurlanish manbai bilan ishlov berilganda yutilish chiziqlari surilishi inobatga olgan holda molekulyar deformatsiyaga uchragan (ya'ni nuqsonlar hosil boʻlgan).

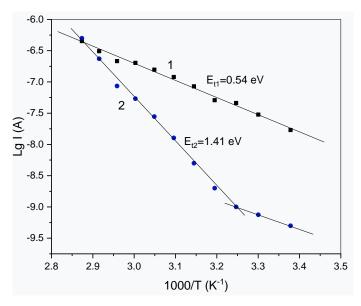
Dissertatsiyaning "Paxta tolalarining elektrofizik va optik xossalarini tadqiq qilish" deb nomlangan toʻrtinchi bobida yod va KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan "Komolot-79" va "Xorazm-150" navliy PT fizikaviy xossalarini tadqiq qilish natijalar keltirilgan. KMnO<sub>4</sub> va yod bilan legirlagan "Xorazm-150" navliy PT VAX, shuningdek KMnO<sub>4</sub> bilan legirlagan "Xorazm-150" navliy PT legirlash vaqtining elektroʻtkazuvchanlikka ta'siri aniqlandi.



10-rasm. "Xorazm-150" navli paxta tolalarining legirlanmagan (1) va KMnO<sub>4</sub> bilan turliy vaqtlarda legirlangan (2,3 va 4) namunalarining VAX. t, soat: 2-1.0; 3-3.0; 4-6.0, UB nur ostida (5), shuningdek yod bilan legirlangan (6) T=297 K

Legirlanmagan namunaga kuchlanish berganimizda xususiy o'tkazuvchanlik xisobiga juda kichik miqdorda tok o'tganligi (100 kuchlanishda 0,15 nA) (10-rasm 1chiziq). Diffuziya yoʻli bilan namunaga kiritma kiritish orqali boshlang'ich o'tkazuvchanlikga nisbatan yoʻqori oqimiga tok erishildi. Legirlash vaqtiga bogʻliq toladan o'tayotgan sezilarliy oshganligi kuzatildi (10rasm 2,3,4-chiziqlar). Quydagi 10rasmdan koʻrishimiz mumkinki. diffuziya vaqtini 1, 3, va 6 soat tartibda oshirish orqali namunaning elektro'tkazuvchanligi ham chiziqliy bo'lmagan ma'lum bir gonuniyat bo'vicha

borganligi kuzatildi. Ushbu hodisa suqulma kirishma moddalar diffuziyasi jarayoniga misol boʻla oladi. Bu qattiq jisimlardagi diffuziya jarayonining eng sodda va yorqin misolidir. KMnO<sub>4</sub> bilan 6 soat davomida legirlangan "Xorazm-150" navliy PT hv=5 eV nur ostida olingan VAX kuzatildi (10-rasm 5-chiziq).

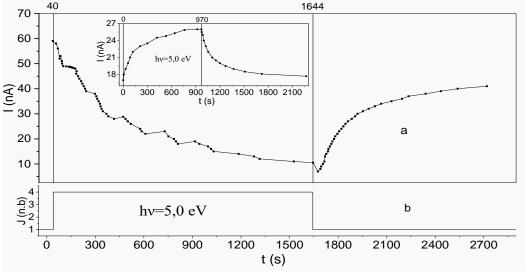


11-rasm. KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan (1) va yod bilan legirlangan (2) "Xorazm-150" navliy PT elektro tkazuvchanligining haroratga bogʻliqligi.

"Xorazm-150" navliy PT elektro'tkazuvchanlikni haroratga bogʻliqligi oʻrganildi. 11-rasmda yod va KMnO<sub>4</sub> "Xorazm-150" legirlangan navliy PTorqali o'tgan elektr tokining haroratga bogʻliqligi natijalari keltirilgan. Natijalarga ko'ra, KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan namunada E<sub>t1</sub>=0.54 eV va yod bilan legirlangan namunada  $E_{t2}=1,41$ eV aktivlanish energiyasi bilan eksponentsial ravishda ortgan.

Yod va KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan "Xorazm-150" navli PT namunalarida fotoo'tkazuvchanlik kinetikasi

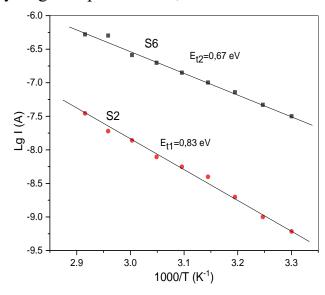
oʻrganildi. Natijalarga koʻra, UB nur (λ=254 nm) bilan yoritilganda KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan namunada fototokning eksponensial oʻsishi va UB nur oʻchirilganda fotooʻtkazuvchanlikning uzoq muddatli relaksatsiyasi kuzatildi va bu taxminan 23 minut davom etdi (12-ichki-rasm). Yod bilan legirlangan "Xorazm-150" navli PT namunasida esa yarimoʻtkazgich materiallarda kamdan kam uchraydigan noyob hodisa ya'ni manfiy fotooʻtkazuvchanlik hodisasi kuzatildi (12-rasm).



12-rasm. Yod bilan legirlangan "Xorazm-150" navli PT namunasining FO' kinetikasi (ichki rasm KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan). hv =5,0 eV, T=300 K

 $\gamma$ - $^{60}$ Co nuranish manbai bilan 1,2·10 $^6$  ren miqdorda nurlantirilgan va yod bilan legirlangan "Komolot-79" navli PT S6 namunasi, shuningdek solishtirish maqsadida faqat yod bilan legirlangan PT S2 namunalarida elektr oʻtkazuvchanligining haroratga bogʻliqliklari oʻrganildi (13-rasm). +20÷80°C harorat diapazonida elektr toki mos ravishda S2 uchun 0,83 eV, S6 uchun 0,67 eV aktivlanish energiyasi bilan eksponensial oʻsadi.

 $\gamma$ -60Co-nurlanish manbai bilan 1,2·106 ren miqdorda nurlantirilgan va yod bilan legirlangan PT fotooʻtkazuvchanlik spektri oʻrganildi (14-rasm). Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, namuna qorongʻida uzoq vaqt (1,5 soat) ushlab turilgandan keyin yorugʻlik spektri hv=0,68 eV dan boshlab fotooʻtkazuvchanlik sezilarliy darajada

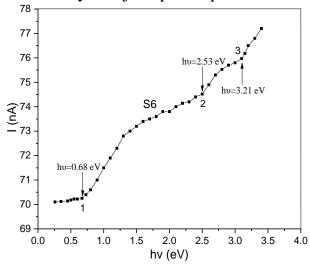


13-rasm. Yod bilan legirlangan va γ-nur bilan ishlov berilgan PT tok oqimining haroratga bogʻliqligi.

orta boshlagani kuzatildi. Foton energiyasi ortib borishi bilan maksimal hv=2,53 eV da kuzatildi va yorugʻlik nurining spektri taxminan hv=3,21 eV ga yetganda yana bir tok oshishi kuzatildi. Ushbu FOʻ spektrini PT taqiqlangan zona oraligʻining yuqori yarmida chuqur donor sathi mavjudligi bilan tushuntirish mumkin.

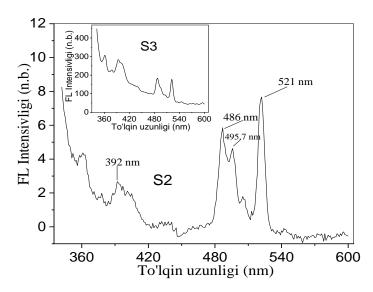
15-rasmda yod bilan legirlangan S2 va sof S3 "Komolot-79" navli PT namunalarining barqaror holatdagi fotolyuminessensiya (FL) spektrlari koʻrsatilgan. S2 namunaning FL spektri taxminan 341 dan 532 nm gacha boʻlgan spektral diapazonni va 392, 486, 521 nm boʻlgan asosiy

maksimumlarni qamrab oldi. Ammo S2 namunaning umumiy emissiya intensivligi S3 namunaga nisbatan sezilarliy darajada pastroq.



14-rasm 5 soat γ-<sup>60</sup>Co-nurlanish manbai bilan nurlantirilgandan keyin yod bilan legirlangan "Komolot-79" navli PT fotoo'tkazuvchanlik spektri

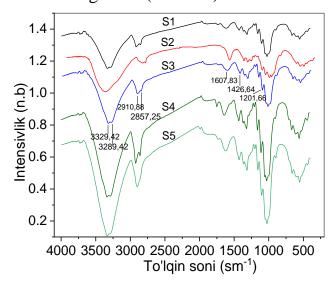
S3 namunasi uchun 394.7, 488, 523 nm markazida joylashgan nisbatan tor FL maksimumlari kuzatiladi. Ikkala namuna uchun ham barcha maksimumlar pozitsiyasi deyarli oʻxshash boʻlsada, FL spektrlarining soni, intensivligi va shaklida sezilarli farqlar mavjud.



15-rasm. 340 nm toʻlqin uzunlikdagi nur bilan uygʻotilgan sof S3 va yod bilan legirlangan S2 PT namunalarining FL spektrlari

Buni quyidagicha tushuntirish mumkin: PT merserizatsiya qilinib yod bilan legirlanganda strukturaviy tuzilishiga ta'sir qiladi va PT konformatsion nuqsonlari ortadi. Shuningdek, PT zanjirining tartibi kamayadi va amorf hududning koʻpayishiga olib keladi. S2 namunasida 495,7 nm qoʻshimcha maksimumning koʻrinishi bu koʻrsatkichni tasdiqlaydi.

Kimyoviy, radiaktiv va termik ishlov berilgan "Komolot-79" navli PT namunalarining strukturasini oʻrganish uchun IQ spektroskopiya usuli yordamida tuzilishi oʻrganildi (16-rasm).



16-rasm. Kimyoviy, radiaktiv va termik ishlov berilgan "Komolot-79" navli PT IQ spektroskopiya natijalari

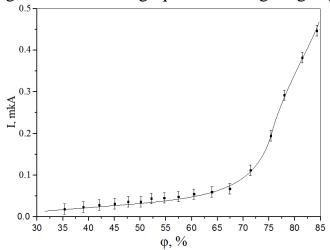
 $\gamma$ -60Co-nuranish **S**1 namuna manbai bilan 1,2·10<sup>6</sup> ren migdorda nurlantirilgan PT, S2 namuna yod bilan legirlangan PT, S3 namuna sof PT, namuna merserizatsiya qilingan PT, S5 namuna γ-60Conuranish manbai bilan 28,4·10<sup>6</sup> ren migdorda nurlantirilgan PT. Sof PT tahlil gilinganda sellyuloza molekulasidagi OH-guruhiga tegishli valent tebranish yutilish chiziqlari 3329,42 sm<sup>-1</sup> va 3289,42 sm<sup>-1</sup>, CH<sub>2</sub>guruhining valent tebranish chiziqlari 2910,88 sm<sup>-1</sup> va 2857,25 sm<sup>-1</sup>, C=0 guruhining valent tebranish yutilish chiziqlari 1607,83  $sm^{-1}$ ,

guruhining assimmetrik deformatsion tebranishi yutilish chiziqlari 1426,64 cm<sup>-1</sup>, C–OH guruhining valent tebranishi 1201,66 sm<sup>-1</sup> sohada yutilish chiziqlari mavjudligi kuzatildi (S3 namuna).  $\gamma$ -60Co nurlanish manbaida 1,2·106 ren miqdorda nurlantirilgan PT namunasini IQ spektroskopiya yordamida tahlil qilinganda sof namunasiga nisbatan yutilish chiziqlarida deyarli oʻzgarish kuzatilmadi (S1 va S3

namunalar). Ammo  $\gamma$ - $^{60}$ Co nurlanish manbaida 28,4· $10^6$  ren miqdorda nurlantirilgan PT namunasini IQ spektroskopiya natijalarida quyidagicha oʻzgarish kuzatildi. OH guruhining valent tebranishi 3329,42 sm $^{-1}$  dan 3332,96 sm $^{-1}$  ga yuqori intensivlikda yutilish chiziqlari surilganligi kuzatildi (S5 namuna). Sellyuloza tarkibidan CH<sub>2</sub>-guruhining 2910,8 sm $^{-1}$  va 2857,25 sm $^{-1}$  sohadagi yutilish chiziqlari 2898,56 sm $^{-1}$  sohaga siljiganligi kuzatildi. Sellyuloza tarkibidagi C=0 guruhining yutilish chiziqlari 1607,83 sm $^{-1}$  dan 1621,87 sm $^{-1}$  sohaga siljigan.

S1 va S5 namunalarda barmoq izi sohada oʻzgarish kuzatilmagan, radioaktiv nur ta'siri ortib borish hisobiga molekulyar deformatsiyaga uchragan (ya'ni nuqsonlar hosil boʻlgan). Yuqoridagilarga qoʻshimcha ravishda mersilizatsiya qilingan PT S4 namunaning IQ spektroskopiya natijalariga koʻra 2 va 3 uglerod atomidagi OH guruhining H harakatchanligi kamaytirish maqsadida NaOH bilan ishlov berilganda H bilan Na almashinadi va 439,56 sm<sup>-1</sup> sohada yutilish chiziqlari kuzatildi. Termik ishlov berish orqali yodning 7% spirtdagi eritmasi bilan legirlangan PT S2 namunasining IQ spektroskopiya natijalari quyidagicha tahlil qilindi. Sellyuloza tarkibidagi OH- guruhining valent tebranishi 3329,42 sm<sup>-1</sup> va 3289,44 sm<sup>-1</sup> dan 3446,49 sm<sup>-1</sup> sohaga surilgan, CH<sub>2</sub> – guruhining valent tebranishi 2910,88 sm<sup>-1</sup> va 2857,25 sm<sup>-1</sup> dan 2896,04 sm<sup>-1</sup> va 2855,57 sm<sup>-1</sup> sohaga surilgan, C=0 guruhining valent tebranishi 1607,83 sm<sup>-1</sup> dan 1635,88 sm<sup>-1</sup> sohaga surilgan va barmoq izi sohada oʻzgarish kuzatilgan ya'ni, I<sub>2</sub> oʻzaro qisman ion, qisman kovalent va deformatsion bogʻlar bilan bogʻlangan.

Tabiiy tolalar asosida tavsiya qilingan datchiklar. Namlik datchigi: Taklif etilgan namlik datchigi qurilmalarning sezgirligini oshirish, shuningdek, strukturani



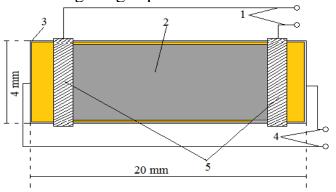
17-rasm. Yod bilan legirlangan bambuk tolasi namunasida elektr oʻtkazuvchanligining nisbiy namlikka bogʻliqligi

soddalashtirish va sensor uchun sarflanadigan harajatlarni pasaytirish vazifasiga asoslangan. Ushbu vazifaga BT namlikni sezuvchi element sifatida ishlatilishi, suyuq shisha va grafit kukuni aralashmasiga asoslangan elektr o'tkazuvchan yelim asosida omik kontakt olish bilan erishildi. Oʻrganishlarga koʻra nisbiy namlikning ortishi bilan BT elektro'tkazuvchanligi 17-rasmda ko'rsatilgan ortadi gonuniyat bilan tolaning namlikka nisbatan

sezgirligining pastga siljishiga olib keladi. Shu bilan birga, tolaning elektr oʻtkazuvchanligi namlikning 1% ga oshishi bilan ham ortishni boshlaydi. BT asosida namlik datchigi ishlab chiqarish texnologiyasi taklif qilindi (18-rasm). Sensor namlikni oʻlchashdan oldin quruq boʻlishi kerakligi sababli, sensor bazasini kerakli haroratgacha qizdirish mumkin. Buning uchun sensorning asos materiali sifatida 20x4x1 mm boʻlgan keramik taglik tanlangan. BT oldindan quritish uchun keramik asosga isitish elementi oʻrnatiladi, u orqali elektr toki oʻtganda, element qiziy

boshlaydi va shu bilan keramik asos hamda BT isitiladi. Isitish tizimi qalin qatlamli texnalogiya asosida yasaldi, ya'ni, silikat shishaga RuO<sub>2</sub> legirlash orqali tayyorlandi. Namlikni o'lchash vaqtida haroratni aniqlash uchun kremniy asosidagi diod haroratga sezgir element sifatida tanlangan. Ushbu versiyada indikator shkalasining maxsus moslashtirishga (kalibrlash) ehtiyoj yo'q. Namlik o'lchagich havo namligini o'lchagich sifatida ishlatiladi, uni havo namligining miqdoriy o'lchamini nazorat qilish zarur bo'lgan turli sistemalarga moslash mumkin; Texnik xususiyatlari: Nisbiy namlikni +5 dan +40°C gacha harorat oralig'ida o'lchash diapazoni 20 dan 100 % gacha.

Haroratga bogʻliq holda namlikni oʻlchash xatosi, %: ±2 dan ±5 gacha.



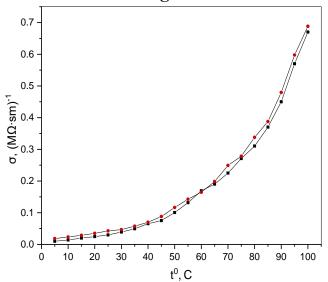
18-rasm. BT asosidagi nisbiy namlik datchigi1 - datchikning chiqish kontaktlari, 2 - bambuk tolalar, 3 - keramik asos, 4 - isitish tizimi kirish kontaktlari, 5 - tok oʻtkazuvchi yelim.

Shunday gilib, bambuk tolalaridan namlik o'lchagich datchik sifatida foydalanish har harorat sharoitida atrofmuhit namligini o'lchashga qodir bo'lgan turli maqsadlar uchun nisbiy namlik o'lchagichlarni ishlab chiqarish texnologiyasini sezilarli soddalashtirishi darajada mumkin.

Bambuk va paxta tolalarining fotoelektrik xossalarini oʻrganish

natijalariga koʻra, yorugʻlik oʻchirilganda fotooʻtkazuvchanlik kamayishi bambuk tolalarida paxta tolalariga karaganda bir necha marta tezroq ekanligi kuzatildi. Bu bambuk tolalari asosida fotoqabulqilgichlar yaratishda ustunligini koʻrsatadi.

Xarorat datchigi: 0-100°C harorat intervalida "Xorazm-150" navli PT



20-rasm. KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan "Xorazm-150" navli PT namunasida elektr oʻtkazuvchanligining haroratga bogʻliqligi.

namunalarini bir necha marta "qizdirish-sovutish" jarayonida elektro'tkazuvchanlik gisterezisi yo'q ekanligi qayd qilindi (20-rasm) va bu "Xorazm-150" navli PT asosida harorat o'lchash datchigini yaratish imkonini beradi.

Ushbu natijaga koʻra passiv hamda aktiv elementlarni o'z ichiga olgan "Aqlli kiyim texnologiyasi" (Smart Clothing Technology) to'qimachilik sxemasini amalga oshirish imkoniyatini koʻrsatadi. Bu kelajakda elektronika va to'qimachilik o'rtasida integratsiyaga yo'l ochadi.

#### **XULOSA**

- 1. 80 °C o'zgarmas havo kamerasida yod bilan legirlangan bambuk tolalari va "Komolot-79" navli paxta tolalaridan 80 V o'zgarmas kuchlanishda o'tayotgan tok harorat ortishi bilan eksponensial qonun bo'yicha ortdi va aktivatsiya energiyalari mos ravishda E<sub>t1</sub>=E<sub>c</sub>-0,57 eV va E<sub>t2</sub>=E<sub>c</sub>-0,83 eV ga teng ekanligi aniqlandi.
- 2. Yod bilan legirlangan bambuk tolalarini  $\lambda$ =254 nm to'lqin uzunlikdagi yorug'lik bilan yoritilganda (hv $\geq$ E<sub>g</sub>) fototokning o'sishi va yorug'lik o'chirilganda fotoo'tkazuvchanlikning uzoq muddatli relaksasiyasi (250 s) aniqlandi, hamda ularning zonaviy diagrammasi tavsiya qilindi.
- 3. Yod bilan legirlangan "Xorazm-150" navli paxta tolalarini λ=254 nm to'lqin uzunlikdagi yorugʻlik bilan yoritilganda manfiy fotooʻtkazuvchanlik fenomeni aniqlandi.
- 4. "Xorazm-150" navli paxta tolalarini KMnO<sub>4</sub> bilan 80 °C oʻzgarmas haroratda diffuziya vaqtini 1, 3, va 6 soat tartibda oshirish orqali tolalarning elektroʻtkazuvchanligi chiziqliy boʻlmagan qonuniyat boʻyicha ortishi aniqlandi.
- 5.  $\gamma$ -60Co bilan nurlantirilgan bambuk tolalari va "Komolot-79" navli paxta tolalarining elektroo'tkazuvchanligi  $\gamma$  nurlanish dozasiga bog'liqligi aniqlandi va  $1.2 \cdot 10^6$  ren va  $28.4 \cdot 10^6$  ren diapazonidagi radioaktiv nur tabiiy tolalarda Frenkel nuqsonlarini hosil qilishi isbotlandi.
- 6. KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan bambuk tolalari uchun aktivatsiya energiyasi  $E_{t1}$ =1,05 eV, "Xorazm-150" navli paxta tolalari uchun esa  $E_{t2}$ =0,54 eV ga tengligi hamda ushbu tolalardan 80 V kuchlanishda o'tayotgan tok harorat ortishi bilan eksponensial qonun bo'yicha ortishi aniqlandi.

# НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И МИКРОЭЛЕКТРО-НИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА УЗБЕКИСТАНА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА УЗБЕКИСТАНА НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

#### НОРБЕКОВ ШОХЗОД МАМАРАСУЛОВИЧ

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ДИСКРЕТНЫХ ПРИБОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ

01.04.10 – Физика полупроводников

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ НАУКАМ

Тема диссертации доктора философии (PhD) по физико-математическим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за B2022.4.PhD/FM819.

Диссертация выполнена в Научно-исследовательском институте физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (ispm.uz) и на Информационно-образовательном портале «ZiyoNet» (www.ziyonet.uz).

Научный руководитель: Мамадалимов Абдугафур Тишабоевич

доктор физико-математических наук, академик

Официальные опноненты: Зикрилаев Нурилла Фатхуллаевич

доктор физико-математических наук, профессор

Шарибаев Насирджон Юсупжанович

доктор физико-математических наук, профессор

Ведущая организация:

Институт ядерной физики Академии наук

Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится «26» « 02 » 2024 г. в 12 часов на заседании Научного совета DSc.03/30.12.2019.FM/Г.01.12 при Научно-исследовательском институте физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана (Адрес: 100057, Узбекистан, г.Ташкент, ул. Янги Алмазар, дом 20. Тел: (+99871)248-79-94,факс: (+99871) 248-79-92, e-mail: info@ispm.uz (зал заседаний НИИ ФПМ при НУУз).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном Центре института (зарегистрирована за № 6.3) по адресу: 100057, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Янги Алмазар, дом 20. Тел: (+99871) 248-79-59.

Автореферат диссертации разослан «\_//\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. (реестер протокола рассылки № \_\_\_\_\_\_ 5\_\_\_3 от \_\_\_\_\_ //\_. \_\_\_\_\_ 2024 г.).

Ш.Б. Утамурадова, председатель Научного совета по присуждению ученых степеной, д.ф-м.н., профессор

Ж.Ж. Хамдамов,

ученый секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, PhD, с.н.с.

н.А. Тургунов председатель научного семинара при научном совете по присуждению

ученых степеней, д.ф-м.н., доцент

14111-41

38ZO & UBLE

## ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее время во всем мире активно развивается область физики полупроводников, в котором пристальное внимание уделяется проведению научных исследований по определению физических свойств природных полупроводниковых волокон. Масштабные и всесторонние исследования природных полупроводниковых волокон в глобальном масштабе требуют открытия новых физических законов, а также создания и внедрения на их основе весьма совершенных новых дискретных элементов электронной техники.

Сегодня научно-исследовательская мире ведется деятельность, исследование физических процессов, направленная происходящих природных полупроводниках. Роль природных волокон особенно важна в области нанофизики. В связи с этим одной из важнейших задач в этом направлении является проведение следующих целевых научно-исследовательских работ: определение фундаментальных параметров природных полупроводниковых волокон; повышение эффективности электрофизических, фотоэлектрических и оптических свойств путем химической, термической и радиоактивной обработки природных полупроводниковых волокон; продемонстрировать закономерности зависимости электропроводности от температуры и спектра света; определение закономерностей зависимости времени легирования температуры электропроводности, легированных полупроводниковых **ХЛОПКОВЫХ** бамбуковых волокон; показать возможности создания новых элементов электронной техники; изучаить механизмы электронных процессов в различных природных полупроводниковых волокнах.

В нашей республике исследователи работают над повышением физической эффективности природных волокон. В связи с этим определение новых типов природных полупроводниковых волокон имеет большое научное значение. С этой точки зрения, учитывая оптимальные электрофизические, фотоэлектрические и оптические свойства полупроводниковых материалов на основе бамбуковых и хлопковых волокон, они считаются одними из дешевых и экологически чистых материалов. «Технология умной одежды» (Smart Clothing Technology), включающая в себя пассивные и активные элементы из природных волокон, показывает возможность реализации текстильной схемы. Это открывает путь к будущей интеграции электроники и текстиля. В литературе очень мало информации по изучению физических свойств природных волокон и существует множество нерешенных проблем, связанных с ИХ электрофизическими свойствами.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан УП- 6097 от 29 октября 2020 года "Об утверждении концепции развития науки до 2030 года", указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы", решении Президента Республики Узбекистан РП № 5011 от 2 марта 2021 года "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической и электронной промышленности и повышению конкурентоспособности

отечественной продукции", решении Президента Республики Узбекистан РП-5032 от 19 марта 2021 года «О мерах по повышению качества образования в области физики и развитию научных исследований» и поставленных задач, определенных в других нормативных правовых документах, связанных с данной деятельностью.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики. Данное исследование проведено в соответствии с приоритетами развития науки и технологий республики III «Энергия, экономия энергоресурсов, транспорта, машин и оборудования; развитие современной электроники, микроэлектроники, фотоники, электронной техники».

Степень изученности проблемы. Научные исследования электрофизических и оптических свойств химически и термически обработанных натуральных волокон проводятся в нескольких научно-исследовательских институтах и научных центрах развитых зарубежных стран. В частности, органическую электронику в натуральных хлопковых волокнах исследовали ученый Корнельского университета в США П.Хинесторасис, ученый из Болонского университета в Италии Ф.Беатрис и ученый из французского центра микроэлектроники Прованса Г.Маллиарас.

В Таджикском государственном национальном университете А.Акобирова, С.Мисриян, Ш.Туйчиев, А.Аловиддиновыми изучено влияние фуллеренов  $C_{60}$  на электропроводность природных волокон.

Узбекские ученые, в том числе академики П.К.Хабибуллаев и А.Т.Мамадалимов впервые в мире продемонстрировали полупроводниковые свойства хлопковых и шелковых волокон. Профессорами А.С.Закировым, Ш.У.Юлдашевым, Ж.Ж.Хамдамовым и другими учеными были исследованы электрофизические и оптические свойства полупроводниковых натуральных волокон и показано создание различных полупроводниковых приборов.

Изучение электрофизических и оптических свойств свидетельствует о широких возможностях исследований в этом направлении. Но до сих пор информация об электрофизических и оптических свойствах природных наноструктурных полупроводниковых волокон, а также об их общих физических закономерностей все еще недостаточно.

диссертатционного Связь исследования научноc планами работ научноисследовательских высшего образовательного или где исследовательского учреждения, выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках фундаментальных проектов плана научных исследований Национального университета Узбекистана имени М.Улутбека в соответствии с тематическими планами грантов Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан по теме ОТ-F2-29 "Исследование влияния внешних факторов на физические свойства природных волокон" (03.01.2017-31.12.2020 гг.).

**Целью исследования является** определение электрофизических и оптических свойств природных полупроводниковых бамбуковых и хлопковых волокон.

#### Задачи исследования:

определение спектра фотопроводимости бамбуковых и хлопковых волокон сорта «Комолот-79» и «Хоразм-150» легированных КМпО<sub>4</sub> и йодом, закона электропроводности в зависимости от температуры, а также определение дискретных уровней энергии в запрещенной зоне;

определение влияния внешних факторов на электрофизические свойства, легированных йодом хлопковых и бамбуковых волокон после облучения с использованием источника излучения  $\gamma$ - $^{60}$ Co;

определение кинетики фотопроводимости полупроводниковых волокон хлопка и бамбука;

определение характеристики химически, термически и радиоактивно обработанных образцов хлопкового и бамбукового волокна;

определение спектра фотолюминесценции хлопкового волокна «Комолот-79» и «Хоразм-150»;

рекомендация создания датчиков на основе природных бамбуковых и хлопковых волокон.

**Объектом исследования** являются бамбуковые волокна, хлопковые волокна сортов «Комолот-79» и «Хоразм-150».

**Предметом исследования** является изучение температурной зависимости электропроводности, фотопроводимости и спектров фотолюминесценции бамбуковых и хлопковых волокон.

Методы исследований. В процессе выполнения научной работы были использованы ИК-спектроскопия, современные методы, позволяющие с высокой точностью измерять энергию ионизации глубоких уровней хлопковых и бамбуковых волокон, зависимость электропроводности от температуры, спектры фотопроводимости, спектрофотометрический анализ и спектр фотолюминесценции.

### Научная новизна исследования заключается в следующем:

определено, что ток проходящий через легированные йодом бамбуковые волокна и хлопковые волокна сорта «Комолот-79», экспоненциально возрастает с ростом температуры, при этом такие волокна имеют энергии активации  $E_{t1}=E_{c}$ -0,57 эВ и  $E_{t2}=E_{c}$ -0,83 эВ, соответственно;

впервые определена длительная (250 с) релаксация фотопроводимости в легированных йодом бамбуковых волокнах при освещении светом с длиной волны λ=254 нм (hv≥E<sub>g</sub>) и предложена их классическая зонная диаграмма;

впервые наблюдалось явление отрицательной фотопроводимости в образцах хлопковых волокон сорта «Хоразм-150», легированных йодом;

впервые хлопковые волокна сорта «Хоразм-150» были легированы  $KMnO_4$  при температуре 80 °C в течение 1-го, 3-х и 6-ти часов, и при увеличении времени этого легирования было обнаружено нелинейное увеличение электропроводности волокон:

впервые было установлено, что электропроводность бамбуковых волокон и хлопковых волокон сорта «Комолот-79», облученных  $\gamma$ -<sup>60</sup>Со, зависит от дозы гамма-излучения, и было обнаружено, что радиоактивное излучение в диапазоне  $1,2\cdot10^6\div28,4\cdot10^6$  рентген вызывает дефекты Френкеля в естественных волокнах;

впервые было обнаружено, что для бамбуковых волокон, легированных

 $KMnO_4$ , энергия активации составляет  $E_{t1}$ =1,05 эB, а для хлопковых волокон сорта «Хоразм-150»  $E_{t2}$ =0,54 эB, и ток, проходящий через эти волокна при напряжении 80 B, экспоненциально возрастает с повышением температуры.

#### Практические результаты исследования заключаются в следующем:

разработана технология подготовки образцов, химической, термической и радиоактивной обработки и получения омических контактов для исследования природных полупроводниковых волокон;

с помощью датчика влажности, позволяющий измерять относительную влажность воздуха и других объектов на основе природных полупроводниковых волокон бамбука и хлопка, а также обрабатывая их тепловым, химическим и радиоактивным светом можно управлять электрофизическими свойствами волокон и основании этих результатов было определено, что их можно использовать в качестве актуаторов умной одежды (smart clothing actuators).

Достоверность результатов исследования основана на использовании методов исследования, обладающих высокой чувствительностью и точностью ("Cary Eclipse Fluorescence Spectrometer", "Bruker Invenio S-2021 Fourier transformator spektrometr", "Eye-One Pro mini-spektrofotometr"), а также на многократном повторении результатов, полученных с помощью различных методов.

**Научная и практическая значимость результатов исследования.** Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они раскрывают физические законы природных полупроводниковых бамбуковых и хлопковых волокон. Полученные результаты объясняются расширением теоретических знаний о физических свойствах природных волокон.

Практическая значимость результатов исследований заключается в открытии новых полимерных материалов на основе бамбуковых волокон с полупроводниковыми свойствами. Этот материал может быть использован при создании датчиков влажности для измерения относительной влажности различных объектов и он может быть использован в процессе обучения в магистратуре и бакалавриате.

### Внедрение результатов исследования.

На основе результатов научного исследований полупроводниковых свойств хлопковых и бамбуковых волокон:

Высокая фоточувствительность, полученная за счет радиоактивной, химической и термической обработки хлопковых волокон, а также научные результаты, такие нарпимер отсутствие гистерезиса электропроводности в процессе изменения температуры были проверены при использовании образцов полупроводниковой электроники, изготовленных в АО «ФОТОН» (Справка АО «Узэлтехсаноат» от 18 сентября 2023 года № 04-3/1234). В результате использования приведенных научных результатов рекомендуется изготавливать термо- и светочувствительные элементы при создании электронной схемы из экспериментальных образцов;

на основе разработанных в рамках диссертации технологических режимов в Наманганском инженерно-строительном институте осуществлена радиоактивная и химическая обработка целлюлозных волокон, легированных йодом и КМnO4, при выполнении научно-технических задач проекта по теме ОТ-Ф2-70 «Влияние

температуры, деформации и света на параметры наноразмерных полупроводников в сильном электромагнитном поле», в частности в рамках данного проекта впервые в сверхвысокочастотном электромагнитном поле были получены гомо- и гетероструктуры и исследованы их электрофизические и фотоэлектрические свойства (Справка Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан №-4/17-13/0-09-1142 от 25 декабря 2023 года). Использование результатов научных исследований позволило получить материалы на основе гомо- и гетероструктур с высокыми электрофизическими и фотоэлектрическими свойствами.

**Апробация результатов исследования.** Результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены на 9, в том числе 6 международных и 3 республиканских научно-практических конференциях.

**Публикация результатов исследования.** Всего по теме диссертации опубликовано 15 научных работ. В научных изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских диссертаций ВАК Республики Узбекистан, опубликовано 5 статей, в том числе в 3 зарубежных и 2 отечественных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка опубликованных научных работ, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 106 страниц.

#### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении представлен анализ результатов, полученных различными исследователями по теме диссертации, обоснована актуальность и необходимость темы диссертации, с формированы цели и задачи исследования, определены объекты и предметы исследования, показано соответствие исследований с приоритетными направлениями развития науки и технологий в Республике Узбекистан, описаны научная новизна и практические результаты исследования, обоснована их достоверность, раскрыта теоретическая и практическая значимость приведены сведения о внедрении разработок, полученных результатов, опубликованных результатах утверждения работ, работах структуре диссертации.

В первой главе диссертации **«Обзор литературы по физическим свойствам природных волокон»** анализируются физические свойства, химический состав и современное состояние использования бамбуковых и хлопковых волокон в качестве полимерных материалов.

На основе анализа имеющихся теоретических и экспериментальных данных были сформированы цели и задачи исследования. Научные исследования, определяемые при выполнении работ и исследовательских задач, заключаются в следующем: Определение температурной зависимости электропроводности бамбуковых и хлопковых волокон, легированных йодом и КМпО<sub>4</sub>; определение спектра фотопроводимости полупроводниковых бамбуковых и хлопковых волокон, определение дискретных уровней энергии и определение влияния легирующих элементов на спектр фотопроводимости;

определение спектра фотолюминесценции хлопкового волокна.

Во второй главе диссертации под названием «Технология и измерительные методы подготовки образцов для исследований» описаны подготовка образцов из природных волокон, методы химической, радиоактивной и термической обработки природных хлопковых и бамбуковых волокон, методы исследования электрофизических, фотоэлектрических и оптических свойств природных волокон и описание устройств:

Для проведения исследований был подготовлены образцы  $(4 \times 2 \times 0.8 \text{ мм}^3)$  из стебля бамбука среднего возраста по направлению волокон. Образцы из бамбукового волокна (БВ) промывали дистиллированной водой при температуре 75 °C. Промытые образцы сушили при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для легирования БВ йодом образцы вымачивали в ванне, содержащей 7% раствор йода в спирте, в течение 15 мин при комнатной температуре. Для диффузии покрывающего поверхность йода в волокно его диффундировали в воздушной камере с температурой 75-80 °С в течение разного времени (1-8 часов) в зависимости от задачи исследования. Вышеописанный процесс также использовался для легирования бамбукового волокна с КМпО<sub>4</sub>. В качестве стандарта использовали 1,5 % водный раствор КМпО<sub>4</sub>.

Пробоподготовку хлопкового волокна (XB) также осуществляли практически по вышеуказанной методике и в описанных выше условиях. Только процесс перед промывкой идет по другому.

Сначала волокна из созревшего семени хлопчатника укладывали в параллельном направлении на плоскую поверхность и прочесывали по направлению волокон специальной гребенкой. Примерное количество параллельных волокон 4500-5000 был нарезаны на куски длиной 4 мм.

Волокна хлопка и бамбука подвергались химической обработке, то есть мерсеризовались. После промывки XB выдерживали в ванне с 20 % водном растворе NaOH при температуре 18 °C в течение 2 мин.

После удаления из ванны избыток NaOH, не образовавший химической связи, полностью смывали дистиллированной водой и образцы сушили в стандартных условиях. Этот процесс вытесняет водород из двух нестабильных связей OH целлюлозной матрицы, заменяя H на Na, выделяя при этом  $H_2O$ . Это явление повышает устойчивость целлюлозного волокна к внешним воздействиям и проницаемость примеси.

Поскольку подвижность связей ОН целлюлозы из бамбукового волокна очень мала, время мерсеризации было увеличено до 5 минут. Промытые волокна хлопка и бамбука подвергали радиоактивной обработке источником излучения γ- <sup>60</sup>Со в дозе 65.73 рен/с в течение разного времени, т.е. от 1 минуты до 120 часов.

В третьей части диссертации, озаглавленной «Исследование физических свойств бамбуковых волокон», представлены результаты исследования физических свойств бамбуковых волокон, легированных КМпО<sub>4</sub> и йодом, которые ранее не изучались.

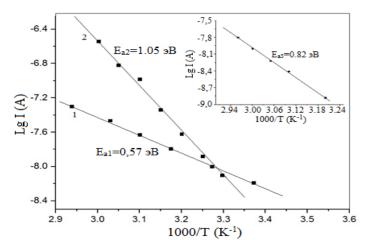


Рис. 1. Температурная зависимость электрического тока проходящего через образцы БВ, легированных йодом (1), КМпО<sub>4</sub> (2) и нелегированных (внутренний график).

На рис. 1 представлена температурная зависимость электрического тока при приложении постоянного напряжения  $U=80~B~\kappa$  образцам BB, легированным йодом и  $KMnO_4$  (диапазон температур  $20-80~^{\circ}C$ ).

Было замечено, что электрический ток, проходящий через образцы, экспоненциально возрастает с ростом температуры. На основе закона Аррениуса энергия активации, полученная из линейной части графика температурной функции при отношении  $10^3/\text{T}$ , составила  $E_{al}$ =0,57 эB,  $E_{a2}$ =1,05 эB,  $E_{a3}$ =0,82 эВ соответственно.

Были исследованы вольт-амперные характеристики (BAX) этих образцов. Исследования проводились в нормальных условиях, в темноте и под светом с длиной волны  $\lambda$ =254 нм.

Было замечено увеличение проводимости при добавлении в образцы примесей (рис. 2). Также ВАХ БВ легированных с  $KMnO_4$  были получены после достижения стационарного состояния под действием света с длиной волны  $\lambda=254$ .

Ток, проходящий через образец, освещенный ультрафиолетовым (УФ) светом, увеличивался с 6,1 нА до 10,2 нА при постоянном напряжении U=100 B, то есть наблюдался внутренний фотоэффект (рис. 2, линия б).

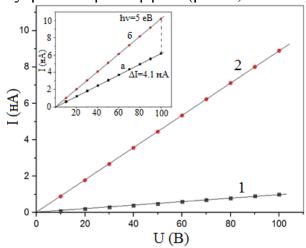


Рис. 2. Нелегированный (1), легированный йодом (2) и легированный  $KMnO_4$  (вставка) BB, в темноте (a) и освещенный ультрафиолетовым  $(У\Phi)$  светом  $(\lambda=254)$ 

nm) (б)

Была исследована кинетика фотопроводимости БВ, легированного йодом (рис. 3). Это исследование показывает, что наблюдалось экспоненциальное увеличение фототока при освещении УФ-светом ( $\lambda$ =254 nm) и долговременная релаксация фотопроводимости при выключении УФ-света. Стационарное значение фотопроводимости достигается не мгновенно, то есть значение насыщения достигается через определенное время после светового воздействия на полупроводник (рис. 3).

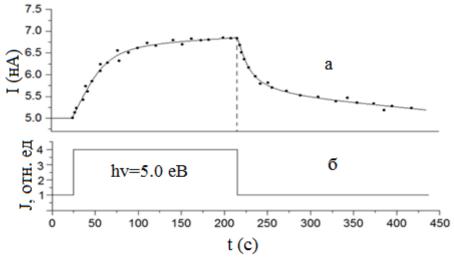


Рис. 3. Кинетика фотопроводимости БВ, легированной йодом, связанная со специфическим оптическим переходом

Изучен спектр фотопроводимости (ФП) БВ, легированного йодом (диапазон энергий светового спектра от 0,26 до 3,5 эВ) (рис. 4). Исследования показали, что после длительного выдерживания образца в темноте (1,5 часа) наблюдалось, что фотопроводимость начала увеличиваться после того, как энергия квантов света достигала hv=0,57 эВ. По мере увеличения энергии фотонов при hv=2,28 и эВ hv=2,85 эВ наблюдаете рост ФП. Такой спектр ФП можно объяснить наличием глубокого донорного уровня в верхней половине запрещенной зоны БВ (рис. 4 и 5).

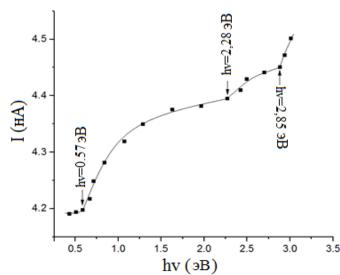


Рис. 4. Спектр фотопроводимости БВ, легированного йодом

Это показывает, что фотопроводимость данного образца БВ связана в основном с процессом образования электронно-дырочных пар на межзонных и межзонных энергетических уровнях.

Если использовать классическую зонную модель полупроводников, то указанную выше фотопроводимость для БВ онжом объяснить следующим Эксперименты образом. показывают, легирование что образца БВ йодом увеличивает фоточувствительность. Если предположить, что йод образует глубокий донорный уровень в верхней половине запрещенной зоны, то начало спектра  $\Phi\Pi$  (hv=0,57 эВ) связано с тем, что энергия ионизации йода в БВ образует глубокий уровень в ширине запрещенной зоны с  $E_c$ -0,57 эВ. Если учесть, что БВ, легированный йодом, обладает проводимостью n-типа, то можно предположить, что уровень с  $E_t$ = $E_c$ -0,57 эВ расположен в верхней половине запрещенной зоны.

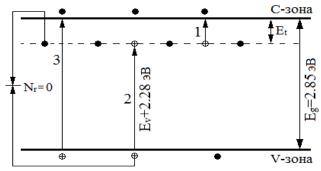


Рис. 5. Диаграмма зон БВ, легированных йодом

ФП Анализ спектра показывает, что уровень с E<sub>t</sub>=E<sub>c</sub>-0,57 эВ обладает донорными свойствами. Монотонный рост ФП в области  $0,57 \le hv \le 2,28$ обусловлен эΒ переходом электронов с уровня Е<sub>t</sub> в зону С (рис. 5, переход рост Дальнейший фотопроводимости от hv≥2,28 эВ обусловлен переходом электронов из V-зоны на уровень E<sub>t</sub> (2-й переход). Увеличение

начиная с hv=2.85 эВ, происходит за счет прямого перехода электронов из V-зоны в C-зону (переход 3). Сравнивая полученные результаты с общепринятыми данными кремния с глубоким уровнем, получим, что значение оптической ширины запрещенной зоны БВ равно  $E_g=0.57+2.28=2.85$  эВ (это значение также подтверждается методом спектрофотометрического анализа БВ. Рис. 9). С технологической точки зрения легированный БВ показывает, что он является фотодетектором, отражающий УФ и видимый диапазон света. Нелегированные образцы БВ имели очень низкие значения коэффициента пропускания и очень небольшую фоточувствительность под воздействием УФ-излучения.

Отсутствие фотопроводимости в образце БВ, легированном йодом, объясняется фотоиндуцированной перезарядкой между молекулами йода и полимерной цепью. На рис. 6 показаны ВАХ образцов БВ, облученных в количестве  $1.2 \cdot 10^6$  ren,  $2.8 \cdot 10^6$  ren,  $5.7 \cdot 10^6$  ren,  $28.4 \cdot 10^6$  ren с помощью источником излучения  $\gamma$ - $^{60}$ Со имеющий в количестве 65.73 ren/s источник излучения. Все образцы имеют одинаковые геометрические размеры и массу. Чистый образец БВ (линия а) сравнивается с нелегированными образцами, облученными соответственно в количестве  $1.2 \cdot 10^6$  ren,  $2.8 \cdot 10^6$  ren,  $5.7 \cdot 10^6$  ren,  $28.4 \cdot 10^6$  ren с помощью источника излучения  $\gamma$ - $^{60}$ Со (линии б, в, г, д).

Согласно результатам, проводимость образцов, обработанных γ-лучами, незначительно увеличивалась с увеличением дозы облучения.

После первой 5-часовой дозы облучения существенного увеличения проницаемости не наблюдалось. Однако обратное наблюдалось в образцах, обработанных  $\gamma$ -лучами в разных дозах и легированных йодом. На рисунке 6 приведены линии необработанных (1-а), легированных йодом (2) и соответственно облученных с источником излучения  $\gamma$ -60Со в количествах 1,2·106 рен, 2,8·106 рен, 5,7·106 рен, 28,4·106 рен, и легированных йодом образцов (3), (4), (5), (6). Согласно результатам, ток, проходящий через образец, легированный только йодом, составил I=8.9 нА при напряжении 100 В, а в радиоактивно

обработанных образцах ток проходил до I=56 нА в зависимости от дозы радиации. Изучен спектр  $\Phi\Pi$  БВ, обработанного  $\gamma$ -лучами и легированного йодом.

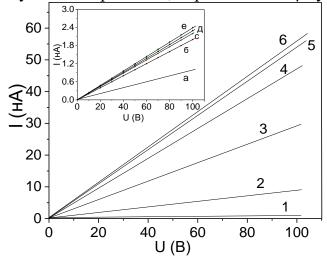


Рис 6. ВАХ БВ, обработанных источником излучения γ-60Co

Эксперименты показывают, что длинноволновая граница ФΠ расположена при hυ=0,46 эВ, что согласуется с энергией полученной ионизации, ИЗ температурной зависимости электропроводности. Тот факт, что фототок в спектре hv=2,39 эВ также увеличился на определенную величину, подтверждает, образце наблюдался вторичный оптический переход. При hv=2,85 эВ наблюдалось резкое увеличение. Йол образует В БВ глубокий донорный уровень E<sub>t</sub>=E<sub>c</sub>-0,46 эВ и подтверждает, что ширина

запрещенной зоны БВ составляет  $E_g$ =0,46+2,39=2,85 эВ (рис. 7).

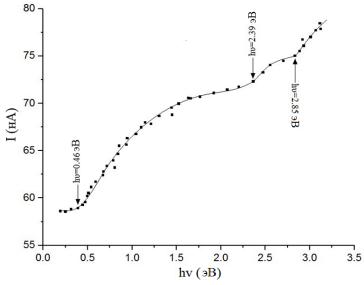


Рис 7. Спектр фотопроводимости БВ, обработанного γ-лучами и легированного йодом

Количественную оценку ширины запрещенной зоны БВ определяли с помощью спектрофотометрического анализа.

Для получения значения энергии межзонного перехода использовалась спектральная зависимость поглощения, определенная подходами Кубелки-Мунка и Тауца в координатах прямых оптических переходов (рис. 8). Путем экстраполяции зависимости  $h\upsilon - (F(R)h\upsilon)^2$  для чистого БВ установлено, что значение запрещенной зоны  $E_g \approx 2,85$  эВ. Это указывает на то, что волокна БВ обладают полупроводниковыми свойствами и имеют высокий потенциал проявления фотокаталитической активности в видимой области света.

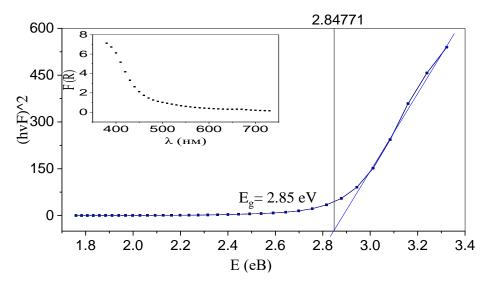


Рис 8. Спектральная зависимость F(R) от длины волны (вставка) и от кривых Тауца (б) для нелегированного чистого БВ.

Методом ИК-спектроскопии исследована структура образцов БВ (рис. 9). Образец A1 — чистый БВ, образец A2 — БВ, облученные в количестве  $28,4\cdot10^6$  рен с помощью источником излучения  $\gamma$ - $^{60}$ Со, образец A3 — БВ облученные в количестве  $1.2\cdot10^6$  рен с помощью источником излучения  $\gamma$ - $^{60}$ Со, образец A4 — БВ, химически обработанный NaOH, образец A5 — БВ, легированный йодом.

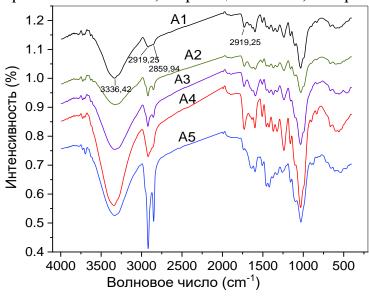


Рис 9. Результаты ИК-спектроскопии БВ

На рис. 10 представлены результаты ИК-спектроскопии образцов БВ. При анализе химически обработанного NaOH образца БТ A4 по сравнению с образцом A1 выявлены что, линии поглощения группы ОН составляют 3336,42 см $^{-1}$ , линии поглощения группы CH=CH - 2919,25 см $^{-1}$ , линии поглощения группы CH $_2$ группы 2859,94 см $^{-1}$ , а линии поглощения группы С=О составляют 1730,55 см $^{-1}$ .

При сравнении спектров поглощения образцов A4 и A1 изменений практически не наблюдается (рис. 9). В результате БВ практически не образовывал химической связи с NaOH. Причина этого в том, что ОН-группа в БВ не обладает кислотным свойством, поэтому можно сделать вывод, что химического процесса практически не происходило. При анализе результатов ИК-спектроскопии образца БВ A5, легированного йодом (I<sub>2</sub>), по сравнению с чистым образцом A1

наблюдались следующие изменения. Группа ОН изменилась от 3336,42 см-1 до 3334,87 см<sup>-1</sup>, группа СН=СН от 2919,25 см<sup>-1</sup> до 2918,35 см<sup>-1</sup>, группа СН<sub>2</sub> от 2859,94 см<sup>-1</sup> до 2850,59 см<sup>-1</sup>, группа С=0 от 1730,55 см<sup>-1</sup> до 1737,96 см<sup>-1</sup>, а также линии поглощения, соответствующие І<sub>2</sub>, наблюдались в области отпечатка пальца 470,77 см-1. Можно добавить, что заметны изменения в области отпечатков пальцев. БВ связан с йодом частично ионными, частично ковалентными и деформационными связями. При анализе результатов ИК-спектроскопии образца АЗ, облученного  $1,2\cdot10^6$  рен в источнике излучения БВ  $\gamma$ - $^{60}$ Со, по сравнению с чистым образцом А1 наблюдались перемещении области группы OH от 3336,42 см<sup>-1</sup> до 3333,6 см<sup>-1</sup>, группы CH=CH от 2919,25 см<sup>-1</sup> до 2921,82 см<sup>-1</sup>, группы CH<sub>2</sub> от 2859,94 см<sup>-1</sup> до 2854,98 см<sup>-1</sup>, а группы C=0 от 1730,55 см<sup>-1</sup> до 1731,98 см<sup>-1</sup>. А для образца А2, облученного  $28.4 \cdot 10^6$  рен в источнике излучения  $\gamma^{-60}$ Со были получены следующие результаты. Наблюдены перемещении линии поглощения группы ОН от 3336,42 см<sup>-1</sup> до 3325,37 см<sup>-1</sup>, группы СН=СН от 2919,25 см<sup>-1</sup> до 2921,45 см<sup>-1</sup>, группы CH<sub>2</sub> от 2859,94 см<sup>-1</sup> до 2853,3 см<sup>-1</sup>, группы C=0 от 1730,55 см<sup>-1</sup> до 1730,98 см-1. В образцах А2 и А3 не произошло изменений в области отпечатков пальцев. В заключение можно сказать, что БВ подвергся молекулярной деформации из-за смещения линий поглощения при воздействии источника излучения  $\gamma$ -60Co (т.е. образовались дефекты).

В четвертой главе диссертации «Исследование электрофизических и оптических свойств хлопковых волокон» представлены результаты исследования физических свойств XB «Комолот-79» и «Хоразм-150», легированных йодом и КМnO<sub>4</sub>.

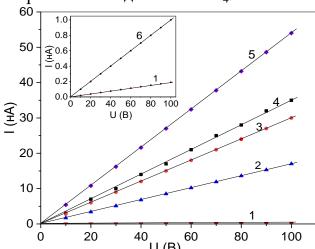


Рис 10. ВАХ хлопковых волокон сорта «Хоразм-150» нелегированных (1) и легированных КМпО<sub>4</sub> в приразных значениях времени (2,3 и 4). t, час: 2-1,0; 3-3,0; 4-6,0, в УФ-свете (5), также легированный йодом (6) Т=297 К

Определено влияние времени легирования на электропроводность XB BAX сорта «Хоразм-150», легированного КМпО<sub>4</sub> и йодом, а также XB сорта «Хоразм-150», легированного КМпО<sub>4</sub>.

При подаче напряжения нелегированный образец наблюдалось, что расчет собственной проводимости переходило небольшое очень (0,15)количество тока нА напряжении 100 В) (рис. 10, линия 1). Большой ток ПО сравнению исходной проводимостью достигался за счет введения в образец примеси путем диффузии.

Было замечено, что ток, проходящий через волокно, существенно увеличивается в зависимости от времени легирования (рис. 10, линии 2, 3, 4).

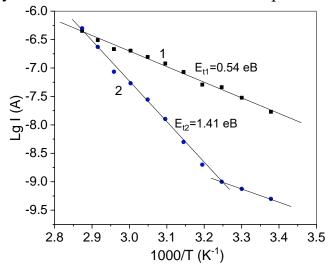


Рис. 11. Температурная зависимость электропроводности XB марки «Хоразм-150», легированного КМпO<sub>4</sub> (1) и йодом

Ниже, на рисунке 10 мы видим, что при увеличении времени диффузии порядка 1, 3 и 6 часов наблюдалось, ЧТО электропроводность образца также увеличивалась ПО определенной нелинейной закономерности. Это явление является примером процесса диффузии растворенных веществ. Это самый простой и яркий пример процесса диффузии в твердых телах. Наблюдали ВАХ, полученно под дейсветствием hv=5 эВ XВ сорта «Хоразм-150», легированных КМпО<sub>4</sub>, в течение 6 часов (рис. 10, линия 5).

(2). Изучена электропроводность XB сорта «Хоразм-150» в зависимости от температуры. На рис. 11 представлены результаты температурной зависимости электрического тока, проходящего через XB сорта «Хоразм-150», легированный йодом и  $KMnO_4$ . Согласно результатам электрический ток возрастал экспоненциально с энергиям активации соответственно равной  $E_{t1}$ =0.54 eV и  $E_{t2}$ =1,41 эВ.

Кинетику фотопроводимости изучали на образцах XB сорта «Хоразм-150», легированных йодом и КМnO<sub>4</sub>. Согласно результатам, в образце, легированном КМnO<sub>4</sub>, наблюдался экспоненциальный рост фототока при освещении УФ-светом ( $\lambda$ =254 nm) и длительная релаксация фотопроводимости при выключении УФ-света, продолжавшаяся примерно 23 мин (вставка на рис. 12).

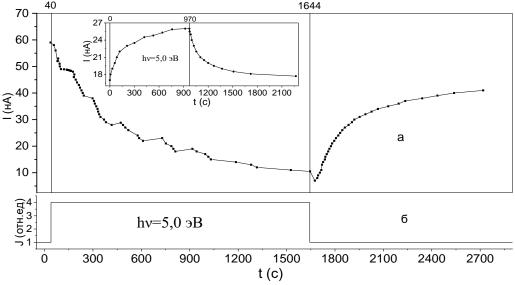


Рис. 12. Кинетика ФП образца XB «Хоразм-150», легированного йодом (вставка, легированный КМnO<sub>4</sub> ). hv =5,0 eV, T=300 K

В образце XB сорта «Хоразм-150», легированном йодом, наблюдалось

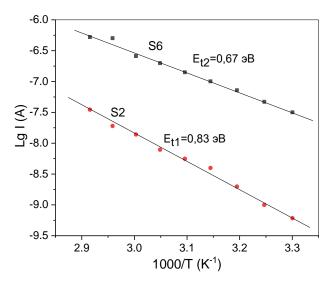


Рис. 13. Температурная зависимость тока XB, легированных йодом и обработанных γ-лучами

0,67 эВ для S6 соответственно.

Исследован спектр фотопроводимости  $\Phi\Pi$ , легированных йодом и облученных в количестве 1,2·106 рен источником излучения  $\gamma$ -60 Со (рис. 14).

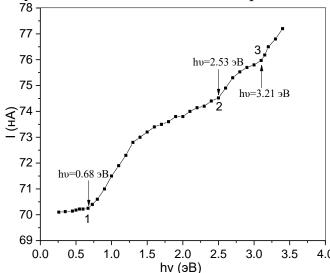


Рис. 14. Спектр фотопроводимости XB «Комолот-79», облученного источником излучения γ-60Со в течение 5 часов и легированного йодом

явление, редко встречающееся в полупроводниковых материалах, а именно отрицательная фотопроводимость (рис. 12).

Температурные зависимости электропроводности исследовали на образце XB S6 сорта «Комолот-79», облученном источником облучения у- $^{60}$ Со в количестве  $1,2\cdot10^6$  рен и легированном йодом, а также для сравнения изучены температурные зависимости электропроводности образцов XB S2, легированных только (13-Рис). В йодом диапазоне температур +20÷80 °С электрический экспоненциально энергией активации 0,83 эВ для S2 и

Исследования показали, после длительного выдерживания (1.5)образца В темноте часа) наблюдалось, что фотопроводимость начала значительно возрастать ИЗ светового спектра hv=0,68 eV. По мере увеличения энергии фотонов наблюдался максимум при hy=2,53 эВ, а еще одно увеличение тока наблюдалось, когда световой спектр достигал приблизительно hy=3,21эВ. Такой спектр ФП можно объяснить наличием глубокого донорного уровня верхней половине запрещенной зоны ХВ.

На Рис. 15 представлены стационарные спектры

фотолюминесценции (ФЛ), легированных йодом образцов S2 и чистого S3 XB сорта «Комолот-79». Спектр ФЛ образца S2 охватывал спектральный диапазон примерно от 341 до 532 нм и основные максимумы при 392, 486, 521 нм. Но общая интенсивность эмиссии образца S2 значительно ниже, чем у образца S3.

С целью изучения структуры химически, радиоактивно и термически

обработанных образцов XB сорта «Комолот-79», было изучено строение методом ИК-спектроскопии (рис. 16).

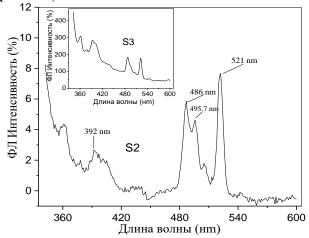


Рис. 15. Спектры ФЛ образцов XB чистого S3 и S2, легированных йодом, возбужденных светом с длиной волны 340 нм

Образец S1 представляет собой ФТ, облученный источником излучения  $\gamma$ -  $^{60}$ Со при  $1,2\cdot10^6$  рен, образец S2 представляет собой XB, легированный йодом, образец S3 представляет собой чистый XB, образец S4 представляет собой мерсеризованный XB, образец S5 облучен источником излучения  $\gamma$ -  $^{60}$ Со при  $28,4\cdot10^6$  рен. При анализе чистого XB наблюдалось наличие линий валентного колебательного поглощения 3329,42 см $^{-1}$  и 3289,42 см $^{-1}$ , принадлежащих OH-группе, 2910,88 sm $^{-1}$  и 2857,25 sm $^{-1}$ , принадлежащих CH2 группе, 1607,83 sm $^{-1}$ , принадлежащих С=0 группе и наличие асимметрического деформационного колебательного поглощения 1426,64 сm $^{-1}$ , принадлежащих CH2 группе, валентного колебания 1201,66 sm $^{-1}$ , принадлежащих C—OH группе в молекуле целлюлозы (образец S3).

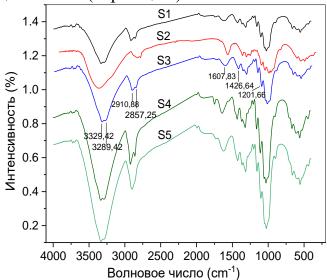


Рис 16. Результаты ИК-спектроскопии химически, радиоактивно и термически обработанного РТ сорта «Комолот-79»

При анализе образца облученного в количестве 1,2.106 рен в источнике излучения  $\gamma^{-60}$ Co, наблюдалось практически не изменения линий поглощения по чистым образцом  $\mathbf{c}$ (образцы S1 и S3). Однако в ИК-спектроскопии результатах образца XB, облученного 28,4·10<sup>6</sup> рен в источнике излучения  $\gamma$ -60Co, наблюдалось следующее изменение.

Обнаружено, что линии поглощения смещаются от 3329,42 см<sup>-1</sup> до 3332,96 см<sup>-1</sup> при большей интенсивности валентного колебания ОН-группы (образец S5). Было обнаружено, что линии

поглощения группы  $CH_2$  в целлюлозе при 2910,8 см $^{-1}$  и 2857,25 см $^{-1}$  сместились к

 $2898,56 \text{ см}^{-1}$ . Линии поглощения группы C=0 в целлюлозе сместились от 1607,83см<sup>-1</sup> до 1621,87 см<sup>-1</sup>. В образцах S1 и S5 не произошло изменения области отпечатка молекулярной деформации образовались дефекты) пальца, (T.e. повышенного воздействия радиоактивного света. дополнение вышесказанному можно сказать, что по результатам ИК-спектроскопии мерсилизованного образца XB S4, для уменьшения подвижности Н ОН-группы на атомах углерода 2 и 3, при обработке NaOH происходит замещение Н на Na, при этом наблюдаются линии поглощения в область 439,56 см<sup>-1</sup>. Результаты ИКспектроскопии образца XB S2, легированного 7%-ным раствором йода в спирте путем термообработки, анализировали следующим образом. Валентное колебание группы ОН- в целлюлозе составляет 3329,42 см<sup>-1</sup> и смещена с 3289,44 см<sup>-1</sup> области на 3446,49 см<sup>-1</sup> область, валентное колебание группы CH<sub>2</sub> составляет 2910,88см<sup>-1</sup> и сдвинуто с 2857,25 см<sup>-1</sup> до 2896,04 см<sup>-1</sup> и 2855,57 см<sup>-1</sup>, валентное колебание группы C=0 сместилось с 1607,83 см<sup>-1</sup> до 1635,88 см<sup>-1</sup> и наблюдалось изменение площади отпечатка пальца, т. е. І2 связан взаимными частично ионными, частично ковалентными и деформационными связями.

#### Рекомендуемые датчики на основе природных волокон.

**Датчик влажности:** В основе предлагаемого датчика влажности лежит задача повышения чувствительности устройств, а также упрощения конструкции и снижения стоимости датчика.

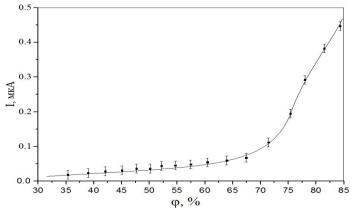


Рис 17. Зависимость электропроводности от относительной влажности образца бамбукового волокна, легированного йодом

Поставленная задача была решена за счет использования в влагочувствительного качестве элемента БΒ, создающего омический контакт основе электропроводящего клея на основе смеси жидкого стекла и порошка графита. Согласно исследованиям, с увеличением относительной влажности БВ электропроводность увеличивается ПО закону, 17, показанному рис. на приводит к сдвигу сторону

уменьшения чувствительности волокна к влаге. В то же время электропроводность волокна начинает увеличиваться с увеличением влажности на 1%.

Предложена технология изготовления датчика влажности на основе БВ (рис. 18). Поскольку перед измерением влажности датчик должен быть сухим, базу сенсора можно нагреть до желаемой температуры. Для этого в качестве основного материала датчика была выбрана керамическая основа размером  $(4 \times 2 \times 0.8 \text{ мм}^3)$ .

Для предварительной сушки БВ на керамической основе устанавливается нагревательный элемент, при прохождении через него электрического тока элемент начинает нагреваться, тем самым нагревая керамическую основу и БВ.

Система отопления выполнена по толстослойной технологии, то есть

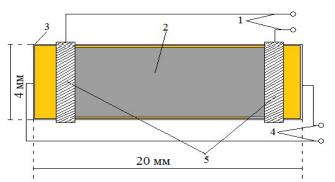


Рис 18. Датчик относительной влажности на основе БВ 1 — выходные контакты датчика, 2 — бамбуковые волокна, 3 — керамическое основание, 4 — входные контакты системы обогрева, 5 — токопроводящий клей.

легированием RuO2 на силикатное В качестве стекло. термочувствительного элемента для определения температуры измерении влажности был выбран диод на основе кремния. В этом исполнении нет необходимости в специальной настройке (калибровке) шкалы индикатора. Влагомер используется в качестве измерителя влажности который может быть адаптирован к различным системам, где необходимо контролировать количественное измерение влажности воздуха; Технические

характеристики: Диапазон измерения относительной влажности от 20 до 100% в диапазоне температур от +5 до +40 °C.

Погрешность измерения влажности, в зависимости от температуры: % от  $\pm 2$  до  $\pm 5$ . Таким образом, использование бамбуковых волокон в качестве датчика влагомера позволяет существенно упростить технологию производства измерителей относительной влажности различного назначения, способных измерять влажность окружающей среды в различных температурных режимах.

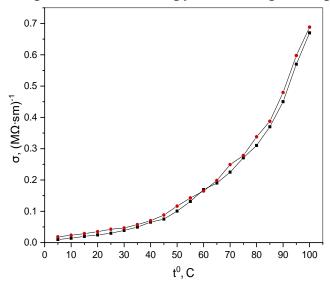


Рис 20. Зависимость электропроводности от температуры в образцах XB сорта «Хоразм-150», легированных KMnO<sub>4</sub>

По результатам исследования фотоэлектрических свойств бамбуковых и хлопковых волокон замечено, что снижение фотопроводимости при выключении света происходит в бамбуковых волокнах в несколько раз быстрее, чем в хлопковых. Это показывает его превосходство в создании фотовосприимчивости на основе бамбуковых волокон.

Датчик температуры: В диапазоне температур 0-100 °С несколько раз было отмечено отсутствие гистерезиса электропроводности при «нагревеохлаждении» образцов XB сорта

«Хоразм-150» (рис. 20) и это позволяет создать датчик температуры на базе XB сорта «Хоразм-150». В соответствии с этим результатом можно реализовать

текстильную схему «Технология умной одежды» (Smart Clothing Technology), включающую пассивные и активные элементы. Это открывает путь к будущей интеграции электроники и текстиля.

### **ВЫВОДЫ**

- 1. Определены энергии активации бамбуковых и хлопковых волокон, «Комолот-79», легированных йодом в камере с постоянной температурой 80 °C, при этом с ростом температуры экспоненциально возрастает ток, проходящего при постоянном напряжении 80 B, которые соответственно составляли  $E_{t1}$ = $E_c$ -0,57 эВ и  $E_{t2}$ = $E_c$ -0,83 эВ.
- 2. В бамбуковых волокнах, легированных йодом обнаружено увеличение фототока при освещении светом с частичным поглощением, то есть светом с длиной волны  $\lambda$ =254 nm (hv $\geq$ E<sub>g</sub>), и наблюдалось длительное ослабление фотопроводимости при выключении света, а также была рекомендована их классическая зонная схема.
- 3. При освещении хлопковых волокон сорта «Хорезм-150», легированных йодом, светом с длиной волны, было обнаружено редкое явление в полупроводниковых материалах, а именно явление отрицательной фотопроводимости.

Явление отрицательной фотопроводимости обнаружено при освещении хлопковых волокон сорти «Хорезм-150», легированных йодом, светом с длиной волны  $\lambda$ = 254 нм.

- 4. Было установлено, что при увеличении времени диффузии хлопковых волокон сорта «Хорезм-150» с КМпО<sub>4</sub> при постоянной температуре 80 °C, электропроводность волокон увеличивается по нелинейному закону, когда время диффузии увеличивалось до 1, 3 и 6 часов.
- 5. Установлено, что электропроводность бамбуковых волокон и хлопковых волокон сорта «Комолот-79», облученных  $\gamma$ -60°Co, зависит от дозы гамма-излучения, и было доказано, что радиоактивное излучение в диапазоне  $1.2 \cdot 10^6 \div 28.4 \cdot 10^6$  рентген вызывает дефекты Френкеля в натуральных волокнах.
- 6. Было обнаружено, что для бамбуковых волокон, легированных  $KMnO_4$ , энергия активации составляет  $E_{t1}$ =1,05 эB, а для хлопковых волокон сорта «Хоразм-150»  $E_{t2}$ =0,54 эB, и ток, проходящий через эти волокна при напряжении 80 B, экспоненциально возрастает с повышением температуры.

# SCIENTIFIC COUNCIL No. DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12 FOR THE AWARD OF ACADEMIC DEGREES AT THE SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS AND MICROELECTRONICS AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

# INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS AND MICROELECTRONICS AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

#### NORBEKOV SHOKHZOD

# INVESTIGATION OF THE SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF NATURAL FIBERS AND RECOMMEND THE CREATION OF DISCRETE DEVICES BASED ON THEM

01.04.10 - Physics of semiconductors

ABSTRACT OF THE DISSERTATION OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) ON PHYSICAL AND MATHETICAL SCIENCES

The theme of the dissertation of the doctor of philosophy (PhD) on physical and mathematical sciences was registered by the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number B2022.4.PhD/FM819.

The dissertation was carried out at the Institute of Semiconductor Physics and Microelectronics at the National University of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation was posted in three (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on the website of the Scientific Council at www.ispm.uz and on the website of "ZiyoNet" Information and Educational Portal at www.ziyonet.uz.

Scientific supervisor:

Mamadalimov Abdugafur Tishaboyevich

doctor of Physical and Mathematical, Academician

Official opponents:

Zikrillayev Nurilla Fatxullayevich

doctor of Physical and Mathematical, professor

Sharibayev Nasirjon Yusupjanovich

doctor of Physical and Mathematical, professor

Leading organization:

Institute of Nuclear Physics Academy of Sciences of

the Republic of Uzbekistan

The dissertation will be defended on 26 07 2024 at 12 hours at the meeting of the Scientific Council No. DSc.03/12.30.2019.FM/T.01.12 at the Research Institute of Semiconductor Physics and Microelectronics at the National University of Uzbekistan at the address: 100057, Tashkent, st. Yangi Almazar, house 20. Tel./Fax: (+99871) 248-79-91 / (+99871) 248-79-92, e-mail: info@ispm.uz.

The dissertation can be found at the Information Resource Center of the Institute (registered under No. 6.3). Address: 20 Yangi Olmazor str., 100057 Tashkent city, Uzbekistan. Tel.: (+99871) 248-79-59, e-mail: info@ispm.uz.

Sh. B. Utamuradova,
Chairwonsay of the Scientific Council for Award
of Acaderic Degrees, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor
J. J. Khamdamov,

Scientific Secretary of the Scientific Council for the Award of Academic Degrees, Doctor of Philosophy (PhD) on Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher

N. A. Turgunov,

Chairman of the Scientific Seminar of the Scientific Council for Award of Academic Degrees, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

#### **INTRODUCTION** (abstract of the PhD dissertation)

The purpose of the study is to determine the electrophysical and optical properties of natural semiconductor bamboo and cotton fibers.

The objectives of the research are bamboo fibers, sort of "Komolot-79" and "Xorazm-150" cotton fibers.

# The scientific novelty of the research consists of the following:

the current passing through iodine-doped bamboo fibers and cotton fibers of the "Komolot-79" grade increases exponentially with increasing temperature, and the activation energies are  $E_{t1}$ = $E_{c}$ -0.57 eV and  $E_{t2}$ = $E_{c}$ -0.83 eV, respectively is determined to be equal;

the first time, a long-term (250 s) relaxation of photoconductivity was determined in bamboo fibers doped with iodine when illuminated with light of a wavelength of  $\lambda$ =254 nm (hv $\geq$ E<sub>g</sub>) and their classical zone diagram was suggested;

the first time, the phenomenon of negative photoconductivity was noted in samples of "Xorazm-150" grade cotton fibers doped with iodine;

the first time, "Xorazm-150" cotton fibers were alloyed with KMnO<sub>4</sub> at a temperature of 80 °C for 1, 3, and 6 hours, and with the increase of this doping time, a nonlinear increase in the electrical conductivity of the fibers was found;

the first time, it was determined that the electrical conductivity of bamboo fibers irradiated with  $\gamma$ -60Co and "Komolot-79" cotton fibers depends on the g radiation dose, and it was found that radioactive radiation in the range of  $1.2 \cdot 10^6 \div 28.4 \cdot 10^6$  ren produces Frenkel defects in natural fibers;

the first time, it was discovered that for bamboo fibers doped with KMnO<sub>4</sub>, the activation energy is  $E_{t1}$ =1.05 eV, and for cotton fibers of the "Xorezm-150" variety  $E_{t2}$ =0.54 eV, and the current passing through these fibers at a voltage of 80 V, increases exponentially with increasing temperature.

## Implementation of the research results.

Based on the scientific results of the study of semiconducting properties of cotton and bamboo fibers:

The unique photosensitivity obtained due to radioactive, chemical and thermal treatment of cotton fibers, as well as the absence of electrical conductivity hysteresis in the process of temperature change, were tested for the use of semiconductor electronic samples made at JSC "FOTON" (Reference No. 04-3/1234 dated September 18, 2023 of the joint-stock company Uzeltexsanoat). As a result of using the cited scientific results, it is recommended to produce temperature and light-sensitive elements in the creation of an electronic circuit from experimental samples;

based on the technological modes developed within the dissertation, treated radioactively and chemically, from cellulose fibers doped with iodine and KMnO<sub>4</sub>, in the performance of the scientific and technical tasks of the project number OT-F2-70 "The influence of temperature, deformation and light on the parameters of nano-sized semiconductors in a strong electromagnetic field" carried out at the Namangan Institute of Engineering and Construction including, within the framework of the project, homo- and heterostructures were obtained for the first time in a heating ultra-high frequency electromagnetic field and used in the study of their

electrophysical and photoelectric properties (Reference No. 4/17-13/0-09-1142 dated December 25, 2023 of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan). The use of scientific results made it possible to obtain homo- and heterostructure materials with unique electrophysical and photoelectric properties based on these materials.

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, four chapters, conclusion, list of references and applications. The text of the dissertation consists of 106 pages.

# E'LON QILINGAN ILMIY IShLAR RO'YXATI СПИСОК ОПУЛИКОВАННЫХ РАБОТ LIST OF PUBLISHED WORKS

#### I boʻlim ( I часть, part I)

- 1. Mamadalimov A. T., Khakimova N. K., Norbekov Sh.M., Yunusov A.Kh., Rai D. P. Study of electrophysical and optical properties of cotton fibers irradiated in γ-60Co radiation source // Fibers and Polymers. 2023, Vol. 24, Issue 12, pp. 1-7. (№3 Scopus, IF:3,9).
- 2. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Nazarov F.. Study on electrophysical properties in KMnO<sub>4</sub>-doped grade "Xorazm-150" cotton fibers // Asian Journal of Research and Reviews in Physics. 2023, Vol. 7, Issue 1, pp. 18-23. (№12 ICV:89.85).
- 3. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Khasanov J. Research on electrophysical properties in KMnO<sub>4</sub>-doped "Komolot-79" grade of cotton fibers // European Journal of Technical and Natural Sciences. 2023, Vol. 2, pp. 30-34. (№12 ICV:85.07).
- 4. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Almardonov Sh. γ-<sup>60</sup>Co nurlanishini "Komolot-79" navli paxta tolalarining elektrofizik xossalariga ta'sirini tadqiq qilish // OʻzMU Xabarlari. 2023, № 1(3), 554-556 b. (01.00.00; №7).
- 5. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M.. Bambuk tolalarning elektrik va fotoelektrik xossalarini tadqiq qilish // Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ma'ruzalari. 2022, № 1, 26-29 b. (01.00.00; №7).

# II boʻlim ( II часть, part II)

- 6. Мамадалимов А.Т., Хакимова Н.К., Норбеков Ш.М. Электрические и фотоэлектрические свойства бамбуковых волокон // Роль передовых инновационных технологий и образования в решении задач автоматизации и энергетики, направленная на повышение энергоэффективности производств и социальной сферы. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Наманган. 2021, 24-25 июнь, с.14-17.
- 7. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M. Bambuk tolalarning elektrofizikaviy xususiyatlarini tadqiq qilish // Yarimoʻtkazgichlar fizikasi, mikro va Nanoelektronikaning fundamental va amaliy muammolari. I Xalqaro anjuman. Toshkent. 2021, 28-29 oktyabr, b.12-13.
- 8. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Xaytimmetov N.B., Oʻrolov A.A. Bambuk tolalarning elektrik va fotoelektrik xossalarini tadqiq qilish // Yarimoʻtkazgichlar va polimerlar fizikasining dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent. 2022, 1-fevral, b.127-129.
- 9. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Rahmonova M.O., Oʻrolov A.A., Rahmonova Z.O. "Xorazm-150" navli paxta tolasining elektrofizik xususiyatlarini tadqiq qilish // Fizika fanining rivojida iste'dodli yoshlarning oʻrni

- (RIAK-XV) Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ishlari toʻplami 2-TOM. Toshkent. 2022, 22-23 aprel, b.127-128.
- 10. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Ismatova M.S., Rahmonova N.O. KMnO<sub>4</sub> bilan legirlangan «Kamolot-79» paxta navi tolalarining elektrofizik xususiyatlarini tadqiq qilish // Fizika fanining rivojida iste'dodli yoshlarning oʻrni (RIAK-XV) Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ishlari toʻplami 2-TOM. Toshkent. 2022, 22-23 aprel, b. 212-214.
- 11. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Nurmatova U.T. Yod bilan legirlangan bambuk poyasining elektrofizik xossalarini oʻrganish // Oʻzbekiston milliy universiteti huzuridagi yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti. Yosh olimlar va fizik talabalarning II Respublika ilmiy anjumani (YOFTRIA- II) materiallari. Toshkent. 2022, 20-21 may, b. 68-71.
- 12. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Alimardonov Sh.A. Study on electrical conductivity in KMnO<sub>4</sub>-doped "Komolot-79" variety of cotton fibers // Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, fotoenergetikada nanostrukturali yarimoʻtkazgich materiallar, III-Xalqaro ilmiy anjumani ma'ruzalar toʻplami. Toshkent. 2022, 24-25 noyabr, b.68-71.
- 13. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Almardonov Sh. The research of the influence of  $\gamma$ -60Co gamma radiation on the electrophysical properties of "Komolot-79" cotton fibers // "O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiyamaliy konferensiya. Toshkent. 2023, 12 may, b.251-253.
- 14. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M., Almardonov Sh.A. γ-60Co-nurlanishini bambuk tolalarining elektrofizik xossalariga tasirini tadqiq qilish // Yarimoʻtkazgich mikro va nanostrukturalarda optik va fotoelektrik hodisalar mavzusidagi VI-Xalqaro anjuman. Fargʻona. 2023, 28-30 sentyabr, b.118-120.
- 15. Mamadalimov A.T., Xakimova N.K., Norbekov Sh.M. "Xorazm-150" navli paxta tolalarining elektrofizik xossalarini tadqiq qilish // Zamonaviy fizikaning fundamental va amaliy muammolari xalqaro konferensiya materiallari. Toshkent. 2023, Oktyabr 19-21, b.75-77.

Avtoreferat « Til va adabiyot ta'limi» jurnali tahririyatida tahrirdan o'tkazilib, o'zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar o'zaro muvofiqlashtirildi.

#### Bosmaxona litsenziyasi:



Bichimi: 84x60 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. «Times New Roman» garniturasi. Raqamli bosma usulda bosildi. Shartli bosma tabogʻi: 3,5. Adadi 100 dona. Buyurtma № 32/24.

Guvohnoma № 851684. «Tipograff» MCHJ bosmaxonasida chop etilgan. Bosmaxona manzili: 100011, Toshkent sh., Beruniy koʻchasi, 83-uy.